博士論文

水素結合の自由度とπ電子物性が相関した 新規有機伝導体の開発

(Development of novel organic conductors with an interplay between

hydrogen bond degrees of freedom and π electronic properties)



目次

第1章 序論	
1-1. 水素結合の自由度	1
1-2. 有機伝導体における水素結合の自由度とπ電子物性	3
1-3. 水素結合で繋がれたユニット構造を基盤とした伝導体	
$-\kappa$ -H ₃ (Cat-EDT-TTF) ₂ -	6
1-4. 本研究の目的	8
1-5. 本論文の概要	11
参考文献	14

第2章 水素結合部の動的な幾何学的自由度が相関した分子配列及びπ電子物性スイッチング現象 -[H₃(Cat-EDO-TTF)₂]BF₄-

2-1. 導入		16
2-2. 結果と考	等察	
2-2-1	中性ドナーH ₂ Cat-EDO-TTFの結晶構造	18
2-2-2.	新規水素結合ユニット型伝導体	
	β'-[H ₃ (Cat-EDO-TTF) ₂]BF ₄ (β'-1・BF ₄)の合成	21
2-2-3.	β'-1·BF4(高温相)の結晶構造	23
2-2-4.	α-1·BF ₄ (低温相)の結晶構造	27
2-2-5.	1·BF 4のπ電子物性	30
2-3. 結論		32
実験		33
参考文献		34

第3章 動的水素結合自由度が相関した π電子物性スイッチング現象の系統的研究:ア ニオン置換による化学圧力効果

•			
3-1.	導入		37
3-2.	結果と考		
	3-2-1.	アニオン置換した水素結合ユニット型伝導体	
		β'- [H ₃ (Cat-EDO-TTF) ₂]X (β'-1·X : X = ClO ₄ , PF ₆ , AsF ₆) の合成	39
	3-2-2.	β'-1·X (X = ClO ₄ , PF ₆ , AsF ₆) の結晶構造	40
	3-2-3.	β'-1·X (X = ClO ₄ , PF ₆ , AsF ₆) のπ電子物性	47
	3-2-4	アニオン置換による異方的化学圧力効果の考察とπ電子物性	
		との相間	50
	3-2-5	β'-1·BF₄の構造相転移メカニズムの考察	53
3-3.	結論		59

実験

参考文献

第4章 多様な水素結合電荷自由度により π 電子系 TTF の酸化状態が制御された純有機 伝導体結晶の開発

4-1. 導入		62
4-2. 結果と考	察	
4-2-1.	新規ドナー分子(H ₂ Cat) ₂ -TTF の合成とその特性評価	64
4-2-2.	(H ₂ Cat) ₂ -TTF を基盤とした伝導体(θ–2)の合成と結晶構造	68
4-2-3	θ-2 のπ電子物性	76
4-3. 結論		78
実験		79
参考文献		82
第5章 総括		83
報文目録		87
講演目録		88
謝辞		89

第1章 序論

1-1. 水素結合の自由度

水素結合は、一般式 A-H…B で表され、プロトンドナーA-H とプロトンアクセプターB からなる非共有結合性の相互作用である (Fig. 1-1)。A, B は電気陰性度の高い酸素や窒素 などの元素が一般的である。Table 1-1 に示すように、水素結合の強さは、共有結合から ファンデルワールスカの間であると言われており、結合の強さによってしばしば 3 つに 大別される[1]。それぞれ、その結合エネルギーの範囲は、強い水素結合相互作用の場合

では、14-40/kcal mol⁻¹、中間の場合は、4-15/ kcal mol⁻¹、弱い場合 1-4/kcal mol⁻¹である。そ して、A···B 間距離 [2.2-2.5 (強い水素結合), 2.2 - 3.2 (中程度の水素結合), 3.2 - 4.0 Å (弱い水素 結合)]やH···B 間距離 (~ 1.2 - 1.5, ~ 1.5 - 2.2, > 2.2 Å)、A-H···B の水素結合角 (170-180, > 130, > 90 °)、A···B 間の水素の位置(A-H≈H···B, A-H <



Fig. 1-1 水素結合 (A-H…B)

H…B, A-H << H…B) などの幾何学的な水素結合のパラメーターは、結合の強さに依存して幅広い数値を有する。このように、水素結合は幾何学的構造において多様な状態が存在する。

Table 1-1 水素結合の各強さにおける水素結合エネルギー、結合長、結合角など一般的特徴 [1]

H-bond parameters Strong		Moderate	Weak
Interaction type Strongly covalen		Mostly electrostatic	electrostatic
Bond energy / kcal mol^{-1}	14 - 40	4 – 15	< 4
Bond lengths (H···B / Å)	~ 1.2 - 1.5	~ 1.5 – 2.2	> 2.2
H-bond length (A····B / Å)	2.2 - 2.5	2.2 - 3.2	3.2 - 4.0
Bond angles A-H···B / °	170-180	> 130	> 90
A-H vs. H····B	$A-H \approx H \cdots B$	$A-H < H \cdots B$	A-H << H•••B

また、しばしば強い水素結合に見られるが、電荷帯びた水素結合が存在する。例えば、 A, B が両方酸素原子である[O-H…O]型の水素結合において,中性の[O-H…O]だけでなく、 カチオン性[O-H…O]⁺やアニオン性[O-H…O]⁻が存在する。また、[N-H…N] 型において も中性の[N-H…N]に加えて、荷電様式の異なる[N-H…N]⁻ や[N-H…N]⁺ の水素結合がみ られる。このように、同一の原子から構成される水素結合においても、多様な荷電様式 が存在する[2]。

上記で述べたように、水素結合は幾何学的または電荷の自由度、すなわち「水素結合の自由度」に基づく多様な結合様式を有している。このような水素結合の自由度は、物質中において、分子配列を制御し、多様な分子構造を構築してきた。さらに、Fig. 1-2 に示すように、水素結合自由度は、温度、圧力、光、電場などの外部刺激によって、動的な変化を示す。



Fig. 1-2 外場応答による水素結合自由度の変化

例えば、Fig. 1-3 に示すように、ATP 合成に見られるプロトン輸送システムでは、 Ubiquinol または Ubiquinone が水素結合を介してプロトン輸送体として働いており、酸化 還元反応と共役して、水素結合部のプロトンが移動する[3]。このように、水素結合の自 由度に由来する動的変化は、生体プロセスにおいて、分子レベルで重要な役割を果たし ている。



Fig. 1-3 生体系に見られる水素結合自由度の動的変化 [3]

1-2. 有機導体における水素結合の自由度とπ電子物性

水素結合に着目した研究は、分子間の反応だけでなく、固体化学や物理の分野においても研究が行われてきた[4]。有機伝導体においても、水素結合を利用した研究が古くから盛んに行われている[5-7]。これまでに、TTF 骨格に水素結合性の置換基を導入したドナー分子を基盤とした伝導体が開発されてきた [6-8]。例えば、Fig. 1-4 や Fig. 1-7 に示すように、水素結合性の置換基であるアミド基[7a] やカテコール縮環した π 電子系 TTF 分子[8b] が合成され、伝導層内、およびアニオンを介した伝導層間が水素結合で繋がった系が数多く報告されている。



EDT-TTF(CONHR)₂ R = H, Me

Fig. 1-4 水素結合置換基を持つπ電子系 TTF 分子である TTF-CONHR [7a]

このような系では、Fig. 1-5の下図に示すように、アニオン(青球、緑球)とドナー分 子間の水素結合部位の距離や角度などの幾何学的な自由度の違いに起因して、π電子系 分子が真上に積み重なる構造や捩じれて積み重なる構造など、多様な分子配列が構築さ れている。



Fig. 1-5 水素結合性の置換基を持つ π 電子系分子と、アニオンとドナー分子間の水素結合の幾何学的自由度に由来した多様な分子配列

例えば、Fig. 1-4 に示したアミド基を有するドナー分子 EDT-TTF(CONHMe)₂を用いた 2 種類の電荷移動塩[EDT-TTF(CONHMe)₂]₂X (X = ClO₄, ReO₄) は、アニオンードナー分子も しくはドナー分子間の水素結合の自由度に由来した異なる分子配列を形成している[7a]。 これらの系では、ドナー分子のアミド置換基同士の分子内水素結合(Fig. 1-6(a))と分子 間水素結合(Fig. 1-6(b))がみられ、アニオンの違いによって結晶中の水素結合様式が異 なっている。Fig. 1-6(c) 示すように、ReO₄塩において、結晶中には分子内水素結合を形 成している 2 種類の結晶学的に異なるドナー分子 A, B が存在しており、ドナー分子 B に 対して ReO₄ アニオンとドナー分子 Aがそれぞれ分子間水素結合を形成している。一方で、 ClO₄塩では、ドナー分子の分子内水素結合は見られず、アニオンードナー分子またはド ナー分子間に水素結合を形成している(Fig. 1-6(d))。この水素結合様式の違いの結果、 ReO₄塩では、ドナー分子 A, B がそれぞれ分離した一次元的積層構造を構築しているのに 対して、ClO₄塩では、β³型と呼ばれる 2 次元的分子配列を形成する。このように、アニ オンとドナー分子間の幾何学的な水素結合自由度に由来して、異なる分子配列を構築し、 これらの分子配列を反映した伝導性が観測されている。



Fig. 1-6 ドナー分子 EDT-TTF(CONHMe)₂の(a)分子内水素結合と(b)分子間水素結合、 [EDT-TTF(CONHMe)₂]₂X((c)X = ReO₄, (d)X = ClO₄)の結晶構造[7a]

上記のように、水素結合自由度の活用は、固体物性研究においても重要であることが これまで示されてきた。しかし、このような系において、π電子物性は分子配列のみに 依存しており、水素結合自由度と π 電子系分子の電子状態は本質的に無関係であるため、 これらの間に直接的な相関はほとんどないと考えられる。

1-3. 水素結合で繋がれたユニット構造を基盤とした伝導体 -κ-H₃(Cat-EDT-TTF)₂-

筆者の研究室においても、これまでいくつかの水素結合性の TTF ドナーが合成されて きた[8]。その中でも、カテコール(Fig. 1-7 で青色部分)が直接 TTF 骨格に縮環したドナ 一分子 (Cat-TTF 誘導体)は、2 つの水酸基を有し、分子の酸化還元と脱プロトン化によ って多彩な電子状態を有することが可能であると考えられる。



Fig. 1-7 カテコール縮環 TTF 誘導体

最近、Cat-TTF 誘導体を用いて、塩基存在下で脱プロトン化しながら電解酸化したところ、脱プロトン型の水素結合で Cat-TTF 誘導体が連結された水素結合ユニット型分子性 導体を見出した[9] (Fig. 1-8)。最も重要なこととして、この系では、水素結合部位が-1 価の電荷を有することと連動して、TTF 部位が酸化(+X) されている。つまり、水素結 合の荷電様式の自由度と π 電子構造が密接に関係したシステムであると言える。例えば、 この様なシステムでは、水素結合中の水素の位置が移動することと連動して、TTF の電 子状態が+X から+Y,+Z へ変化するような相関現象が期待される。



Fig. 1-8 水素結合の自由度とπ電子構造が相関した水素結合ユニット

これまでに、エチレンジチオ体(R = -SCH₂CH₂S-)結晶 [9a-c, e] として κ -H₃(Cat-EDT-TTF)₂が得られている。この伝導体は通常とは異なりアニオンを含んでおら ず、水素結合ユニットのみから構成され、水素結合部位の-1 価に対する電荷補償によっ てそれぞれの TTF 骨格が+0.5 価に酸化されている。その結果、この物質は室温伝導度 $\sigma_{r.t}$ ~3.5 S/cm を示す良導性の純有機単ユニット伝導体となり、これは水素結合の荷電様式 の自由度が π 電子物性と相関した系であると考えられる。



Fig. 1-9 エチレンジチオ体 (R = -SCH₂CH₂S-) であるκ-H₃(Cat-EDT-TTF)₂の水素結合ユ ニット構造と分子配列 [9a-c, e]

1-4. 本研究の目的

本研究では、水素結合の自由度と π 電子状態の相関に基づく新規 π 電子物性、動的 現象の開拓を目指し、Cat-TTF 誘導体を基盤とした水素結合ユニット構造を有する新規有 機伝導体の開発を行った。Fig. 1-10 に示すように、ドナー分子 Cat-TTF の置換基 R を化 学修飾することによって、水素結合ユニットへ電子的効果や立体構造的効果を与えるこ とができると考えられる。つまり、水素結合の自由度とπ電子系との相関が変調された ユニット構造を形成できる。このような新規タイプの相関を有した水素結合ユニット構 造を有する伝導体では、水素結合の自由度とπ電子物性の相関する新規 π 電子物性や動 的現象を実現できると考えられる。例えば、Fig. 1-11 に表すように、水素結合中の水素の 移動がπ電子構造の変化と連動し、系の伝導性や磁性、誘電性などのπ電子物性が劇的 な変化するような、新規の相関現象が期待される。



Fig. 1-10 水素結合ユニット構造における置換基修飾による水素結合の自由度とπ電子 系の相関の変調



Fig. 1-11 水素結合の自由度とπ電子物性の相関の概念図

水素結合ユニットの置換基 R の化学修飾として、Fig. 1-7 に示すような Cat-TTF 誘導体 が考えられる。これらの第一酸化電位を比較すると、Table 1-2 に示すように、チオアル キル基の置換体 R = SMe ($E^{1}_{1/2}$ = +0.39), -SCH₂S- ($E^{1}_{1/2}$ = +0.41), -S(CH₂)₃S- ($E^{1}_{1/2}$ = +0.43) は、 R = -S(CH₂)₂S- (EDT 体, $E^{1}_{1/2}$ = +0.40) とほとんど同程度の酸化電位を有しているが、こ れまでに、水素結合ユニット構造を基盤とした伝導体の合成には至っていない。一方で、 TTF 骨格のセレン置換体 (R = -S(CH₂)₂S-, X = Se, $E^{1}_{1/2}$ = +0.48) は、EDT 体 ($E^{1}_{1/2}$ = +0.40) と大きく酸化電位が異なるが、 κ -H₃(Cat-EDT-TTF)₂ と同型の水素結合ユニット型伝導体 κ -H₃(Cat-EDT-ST)₂ が合成されている[9a]。このことから、ドナー分子の酸化還元活性より 分子の立体構造の違いが水素結合ユニット構造の形成とその集積構造に影響することが 示唆される。

R	Х	$E^1{}_{1/2}$ / V	$E^2_{1/2}$ / V	$\varDelta E / V$
SCH ₃	S	+0.39	+0.64	0.25
-SCH ₂ S-	S	+0.41	+0.65	0.24
-S(CH ₂) ₂ S-	S	+0.40	+0.65	0.25
-S(CH ₂) ₃ S-	S	+0.43	+0.71	0.28
-O(CH ₂) ₂ O-	S	+0.35	+0.62	0.27
-S(CH ₂) ₂ S-	Se	+0.48	+0.76	0.28

Table 1-2 カテコール誘導体 (Fig. 1-7) の酸化還元電位[8b]

そこで、当該研究では、Cat-TTF (Fig. 1-7)の置換基 R として、EDT 基と類似の立体 構造を持つ EDO 基 (R = -OCH₂CH₂O-)が水素結合ユニット構造の集積において優位に 働くと考え、H₂Cat-EDO-TTF 分子を基盤とした水素結合ユニット型伝導体の合成を行っ た。この化学修飾により、ドナー分子の酸化電位(HOMO のエネルギー準位)が変調さ れ、ユニット内の水素結合自由度と π 電子構造に新規の相関が発現すると予想される。 また、EDO 基の酸素原子が関与した分子間相互作用(S…O,O…O,C-H…O etc.)が集積 構造に影響を与えることが期待される。例えば、EDT 基を TTF 両端に有する BEDT-TTF 分子は、その電荷移動塩において、多様な分子配列を持つ集積構造がみられる[10]。一方 で、BEDT-TTF 分子の EDT 基を EDO 基に置換した BEDO-TTF 分子の場合、ドナーの積 層方向に EDO 基の間で C-H…O 型の水素結合を形成することで、多くの電荷移動塩がβ" 型の分子配列を構築する[11]。以上のように、EDT 基から EDO 基への置換によって、水 素結合の自由度とπ電子系の相関が変調されたユニット構造とその集積構造を基にして、 新たな物性や動的現象などが起こることが期待できる。

さらに、水素結合の自由度の拡張を狙った化学修飾として、TTF 両端にカテコールを 縮環させた新規ドナー分子(H₂Cat)₂-TTF(R = *o*-dihydroxybenzene)を合成した (Fig. 1-12)。 先行研究によって合成されたドナー分子 (Fig. 1-7) は、EDT 体と比較して、主に電子構 造や立体構造に変化が見られる。一方、(H₂Cat)₂-TTF では、2 個の水酸基を有するカテコ ール部位が 2 個縮環されることで計 4 個の水素結合サイトを有し、ユニット内の水素結 合および電子的効果に加えて、ユニット間にも水素結合を形成することが可能となる。 また、カテコール部位の脱プロトン化と酸化状態が連動した多様な電子状態によって、 多様な水素結合様式が結晶内に見られると予想される。その結果、ユニット内とユニッ ト間の多様な水素結合が協奏する特異な集積構造を形成し、水素結合とπ電子物性の新 規相関物性が期待される。



Fig. 1-12 (H₂Cat)₂-TTF 分子とカテコール部位の脱プロトン化と酸化還元の連動による 多様な電子状態

1-5. 本論文の概要

本論文では、水素結合の自由度と π 電子物性の新奇相関現象を探索するため、電子構造及び水素結合を制御した 2 種類の Cat-TTF ドナー分子の合成、および水素結合ユニット構造を基盤とした新規有機伝導体単結晶の作製を行い、その結晶構造と電子物性を詳細に調査し、新たな相関物性について述べている。本論文は、以下に示す 5 つの章で構成されている。

第1章

本論文の序論であり、水素結合の自由度、および従来の有機伝導体における水素結合 とπ電子物性との関係について述べた。さらに、水素結合の自由度とπ電子状態の相関 による新たな協奏物性の発現を目指して、筆者の研究室で最近、両者が相関する水素結 合ユニットが作られ、それを基盤とした有機伝導体で新規相関現象の端緒が見いだされ こと、そして本研究では、水素結合ユニット中における分子のπ電子構造および水素結 合を制御して、新たな相関物性を目指しているという研究目的について述べている。

第2章

水素結合ユニット中における分子の骨格を大きく変えず、 π 電子構造を変化させるために、エチレンジチオ(EDT)基をエチレンジオキシ(EDO)基に置換したドナー分子(H₂Cat-EDO-TTF)を合成し、その分子から脱プロトンおよび酸化により新規水素結合ユニット型伝導体β'-[H₃(Cat-EDO-TTF)₂]BF₄(β'-1·BF₄)を作製し、水素結合部の動的な幾何学的自由度が相関した劇的なβ'からα配列への分子配列変化、および磁性及び伝導性の π 電子物性スイッチング現象を見出したことを記述している(Fig. 1-13)[9d]。





第3章

第 2 章において開発された水素結合ユニット型伝導体β'-1・BF₄ と同型構造のアニオン 置換体β'-1・X (X = ClO₄, PF₆, AsF₆) を合成し、アニオン置換による化学圧力効果について、 結晶構造と物性測定を行い調査した。β'-1・BF₄の構造相転移をアニオン置換によって制御 することに成功し、水素結合の自由度を用いた相転移がドナー分子間の化学圧力と、よ り強いスピングレット形成による電子系の安定化と相関していることを述べている。

第4章

水素結合ユニットの水素結合様式をπ電子構造と共に制御するために、両側にカテコ ール縮環した新規対称型ドナー分子((H₂Cat)₂-TTF)を合成し、その分子を基盤とした水 素結合ユニットが構築する伝導体の作製を行った。この系においては、カテコール部位 同士の脱プロトンによる-1価の水素結合だけでなく、ディスオーダーした非脱プロトン 型の中性の水素結合が存在しており、多様な水素結合電荷自由度とπ電子物性が相関し、 すべての TTF 酸化状態がほぼ+0.25 価と制御された脱プロトン酸化型純有機伝導体θ-2を 見出すことに成功したことを記述している (Fig. 1-14)。



Fig. 1-14 (a) (H₂Cat)₂-TTF を脱プロトンおよび酸化して合成した-0.5 価の水素結合ユニット H₃[Cat-H₂Cat-TTF]₂ と(b) 脱プロトン酸化型純有機伝導体**θ**-2を構成する水素結合ユニット(上)とディスオーダーユニット(下)。TTF 骨格の酸化状態は~+0.25 価に制御されている。

第5章

第1-4章について総括を行った。

参考文献

- [1] Jeffrey, G. A. An Introduction to Hydrogen Bonding; OxfordUniversity Press: New York, 1997.
- [2] T. Steiner, Angew. Chem. Int. Ed., 2002, 41, 48.
- [3] E. R. Blankenship, T. M. Madigan, *Anoxygenic Photosynthetic Bacteria; Advances in Photosynthesis*, Vol. 2; Kluwer Acad. Publishers, **1995**.
- [4] (a) T. Mitani, G. Saito, and H. Urayama, *Phys. Rev. Lett.*, 1988, **60**, 2299; (b) T. Akutagawa, T. Hasegawa, T. Nakamura, T. Inabe, and G. Saito, *Chem. A Eur. J.*, 2002, **8**, 4402.
- [5] (a) M. B. Zaman, J. Toyoda, Y. Morita, S. Nakamura, H. Yamochi, G. Saito, K. Nishimura, N. Yoneyama, T. Enoki, and K. Nakasuji, *J. Mater. Chem.*, 2001, **11**, 2211; (b) N. Kobayashi, T. Naito, and T. Inabe, *Adv. Mater.*, 2004, **16**, 1803; (c) H. Minemawari, T. Naito, and T. Inabe, *Cryst. Growth Des.*, 2009, **9**, 4830.
- [6] (a) M. Fourmigué and P. Batail, *Chem. Rev.*, 2004, **104**, 5379; (b) Y. Morita, T. Murata, and K. Nakasuji, *Bull. Chem. Soc. Jpn.*, 2013, **86**, 183.
- [7] (a) S. A. Baudron, N. Avarvari, E. Canadell, P. Auban-Senzier, and P. Batail, *Chem. A Eur. J.*, 2004, **10**, 4498; (b) T. Murata, Y. Morita, Y. Yakiyama, K. Fukui, H. Yamochi, G. Saito, and K. Nakasuji, *J. Am. Chem. Soc.*, 2007, **129**, 10837 (c) Y. Kobayashi, M. Yoshioka, K. Saigo, D. Hashizume, and T. Ogura, *J. Am. Chem. Soc.*, 2009, **131**, 9995.
- [8] (a) S. C. Lee, A. Ueda, H. Kamo, K. Takahashi, M. Uruichi, K. Yamamoto, K. Yakushi, A. Nakao, R. Kumai, K. Kobayashi, H. Nakao, Y. Murakami, and H. Mori, *Chem. Commun.*, 2012, 48, 8673; (b) H. Kamo, A. Ueda, T. Isono, K. Takahashi and H. Mori, *Tetrahedron Lett.* 2012, 53, 4385; (c) S. C. Lee, A. Ueda, A. Nakao, R. Kumai, H. Nakao, Y. Murakami, and H. Mori, *Chem. A Eur. J.*, 2014, 20, 1909; (d) S. J. Krivickas, C. Hashimoto, J. Yoshida, A. Ueda, K. Takahashi, J. D. Wallis, and H. Mori, *Beilstein J. Org. Chem.*, 2015, 11, 1561.
- [9] (a) T. Isono, H. Kamo, A. Ueda, K. Takahashi, A. Nakao, R. Kumai, H. Nakao, K. Kobayashi, Y. Murakami and H. Mori, *Nat. Commun.* 2013, 4, 1344; (b) A. Ueda, S. Yamada, T. Isono, H. Kamo, R. Kumai, H. Nakao, Y. Murakami, K. Yamamoto, Y. Nishio and H. Mori, *J. Am. Chem. Soc.* 2014, 136, 12184; (c) T. Isono, H. Kamo, A. Ueda, K. Takahashi, M. Kimata, H. Tajima, S. Tsuchiya, T. Terashima, S. Uji and H. Mori, *Phys. Rev. Lett.* 2014, 112, 177201. (d) J. Yoshida, A. Ueda, A. Nakao, R. Kumai, H. Nakao, Y. Murakami, and H. Mori, *Chem. Commun.*, 2014, 50, 15557. (e) A. Ueda, A. Hatakeyama, M. Enomoto, R. Kumai, Y. Murakami, and H. Mori, *Chem. A Eur. J.*, 2015, 21, 15020.

- [10] (a) T. Mori, Bull. Chem. Soc. Jpn., 1998, 71, 2509. (b) T. Mori, H. Mori, and S. Tanaka, Bull. Chem. Soc. Jpn., 1999, 72, 179. (c) T. Mori, Bull. Chem. Soc. Jpn., 1999, 72, 2011.
- [11] S. Horiuchi, H. Yamochi, G. Saito, K. Sakaguchi, and M. Kusunoki, J. Am. Chem. Soc., 1996, **118**, 8604.

第2章 水素結合部の動的な幾何学的自由度が相関した分子配列及びπ電子物性スイッ チング現象 -[H₃(Cat-EDO-TTF)₂]BF₄-

2-1. 導入

固相-固相転移や固相転換は、物質科学において最も興味深い現象の一つであり、実 験および理論により広く研究されている。特に、分子性の固体/物質でのこれらの相転移 により、化学的や物理的特性ばかりでなく、機能などを引き出すことが可能である。そ れ故に、この動的現象は構造物性相関に関与した基礎的観点からだけでなく、スイッチ ングやセンサーへの発展など応用的観点からも注目を集めている[1]。例えば、いくつか のチアジルラジカル誘導体は、相転移において分子の配列や配向を大きく変え、結果と して大きな磁気ヒステリシスを持つ二重安定性を与える[2]。興味深いことに、平面性の チアジル骨格間のπ-π相互作用や分子隣接間の S…S や S…N 相互作用はこの特異な相 転移現象の鍵であると考えられている[2e, f]。しかしながら、このような分子間配列変化 を伴う相転移現象は数例あるのみで[3, 4]、このような新規な相転換および相転移の起源 やメカニズムを持つ新規物質のさらなる探索は、この研究分野の課題の 1 つとなってい る。

最近、カテコールがエチレンジチオ TTF (EDT-TTF) に縮環したドナー分子[4] を基盤 とした新規の水素結合性の有機伝導体の合成に成功した[5]。興味深いことに、この伝導 体は、2 つの+0.5 価の Cat-EDT-TTF 骨格がアニオン性の対称的水素結合[O···H···O]⁻によ って繋がれた分子ユニット, H₃(Cat-EDT-TTF)₂,のみから構成されている (Fig. 2-1(a))。こ のように、一般的な有機導体とは異なり、結晶中にはアニオンを含まない。Fig. 2-1(b) に 示すように、ユニットは Cat-EDT-TTF^{+0.5} 骨格間の水素結合部で約 84°の二面角を有して屈 曲している。水素結合ユニット同士は、ユニット片側の Cat-EDT-TTF^{+0.5} 分子同士からな る π ダイマーを形成しており、その π ダイマーは井桁型に配列した、いわゆる κ 型[6] と 呼ばれる、伝導層を形成している (Fig. 2-1(c))。この伝導体, κ -H₃(Cat-EDT-TTF)₂,は低温 まで半導体的挙動を示し、その室温伝導度は $\sigma_{r.t}$ = 3.5 S/cm であり、これまで報告されて きた純有機単成分伝導体の中で一番高い値を示した。

上記のような特異な水素結合ユニットの発見を基にして、第2章ではエチレンジチオ (EDT)基の代わりにエチレンジオキシ(EDO)基を持つCat-EDO-TTFを用いた新規タイ プの水素結合ユニット型伝導体のさらなる探索を行った(Fig. 2-1(d))。この化学修飾で は、ユニットの基盤となるドナー分子は立体構造を大きく変えずに、第一酸化電位が0.398 eVから0.345 eV (0.1 M TBA·ClO₄ / MeCN, vs SCE) へと減少する。その結果、 π 電子系の 構造が変調されることで、水素結合の自由度と新規の相関を有する水素結合ユニット構 造を形成すると考えられる。また、一般的なEDO基の導入に期待されるC-H…O型の水素 結合[7] やS…OやO…Oコンタクトの形成によって、ユニット構造の集積構造に影響を与 えると考えられる。ゆえに、新規のユニット内の相関と集積構造を基にした新たな物性 や動的現象などが起こることが期待される。実際に、この化学修飾は、結晶中の水素結 合ユニットの電子構造、化学組成、分子配列や物性に大きな影響を与え、さらに、二次 元的に積層したCat-EDO-TTF⁺の分子配列の劇的な変化(β ^{*}型配列 ↔ α 型配列)と物性変 化を伴う相転換現象を引き起こした。この相転移において注目すべきことは、ユニット は平面型と屈曲型の間で幾何学的な水素結合変化によって変形していることである。こ れらの結果から、 β' -[H₃(Cat-EDO-TTF)₂]BF₄(β' -1·BF₄)と α -[H₃(Cat-EDO-TTF)₂]BF₄(α -1·BF₄)の間での特異な固相一固相転換が、ユニット内の水素結合自由度とユニット間 の $\pi - \pi$ 相互作用の協同性による構造自由度を媒介としていることが示唆された。



Fig. 2-1 水素結合ユニットの化学構造式 (a) H₃(Cat-EDT-TTF)₂、(d) [H₃(Cat-EDO-TTF)₂]BF₄ とк-H₃(Cat-EDT-TTF)₂ (298 K) の(b) 水素結合ユニットの分子長軸投影図、(c) 分子配列

2-2. 結果と考察

2-2-1 中性ドナーH₂Cat-EDO-TTF の結晶構造

中性ドナー分子 H₂Cat-EDOTTF (Fig. 2-2) の単結晶は、アセトニトリル溶媒を用いた再結晶法により得た。X 線構造解析は Rigaku Mercury CCD (Mo-Kα) を利用して行った。結晶学的データは Table 2-1 に示す。



Fig. 2-2 中性ドナー分子カテコール縮環 EDO-TTF の化学構造式

中性のドナー分子 H₂Cat-EDO-TTF の、C=C 距離は 1.347(8) Å であり、H₂Cat-EDT-TTF の 1.345(7) Å とほぼ同様であった(Fig. 2-3(a))。TTF 骨格が中性の場合、屈曲した構造が見 られることが多いが、H₂Cat-EDO-TTF は平面構造を形成しており、分子のパッキングに 起因していると考えられる(Fig. 2-3(b))。Fig. 2-3 に見られるように、積層方向において、 ドナー分子同士は EDO 基に特徴的な C-H…O 型の水素結合が見られ [7]、一様な積層構 造を構築していた。このため、ドナー分子は同一方向を向いて重なっており(Fig. 2-3(d))、 H₂Cat-EDO-TTF が非対称ドナーであることを考えると、H₂Cat-EDT-TTF のように、分子 内の分極を打ち消す head-to-tail 型の重なり方が安定であると考えられるが(Fig. 2-3(e)) [5a]、EDO 基同士の水素結合(C-H…O) によって積層様式が制御されている。ただし、積 層カラム間では逆方向を向いているため、極性空間群には属していない。



Fig. 2-3 H₂Cat-EDO-TTF 結晶構造:ドナーの (a) 上部, (b) サイド, (c) 積層様式に見られる C-H…O型水素結合, (d) 重なり様式と(e) H₂Cat-EDT-TTF の重なり様式

その結果、EDO 基同士が形成する C-H…O 型水素結合による積層構造を反映して、 H₂Cat-EDO-TTF は、0型の分子配列を形成しており(Fig. 2-4)、H₂Cat-EDT-TTF の K型分子 配列と異なる集積構造を形成していた。このように、EDT 基から EDO 基への置換によっ て自己集積能が変化しており、EDO 基周囲の相互作用に由来した新規分子配列の水素結 合ユニット型伝導体の構築が期待される。



Fig. 2-4 分子配列 (a) H₂Cat-EDO-TTF, (b) H₂Cat-EDT-TTF

	H ₂ Cat-EDO-TTF
Formula	$C_{12}H_8O_4S_4$
Formula Weight	352.50
Crystal System	orthorhombic
Space Group	<i>C</i> 222 ₁ (#20)
Temperature / K	293
λ/Å	0.71073
<i>a</i> / Å	3.999(3)
<i>b</i> / Å	29.96(3)
<i>c</i> / Å	10.493(9)
α / °	90
eta / °	90
γ / °	90
V / Å ³	1257(2)
Z value	4
$d_{\rm calc}$ / g cm ⁻³	1.863
GOF	1.144
<i>R</i> 1 (I >2.00σ(I))	0.0559
wR2 (All data)	0.1363
# of observations	1440
# of variables	96
CCDC	997838

Table 2-1 中性ドナーH₂Cat-EDO-TTF (293 K)の結晶学的データ

2-2-2 新規水素結合ユニット型伝導体β'- [H₃(Cat-EDO-TTF)₂]BF₄ (β'-1·BF₄)の合成

水素結合ユニット型伝導体 β '-1·BF₄は、Scheme 2-1 に従い合成した。アルゴン置換した H型セルに、H₂Cat-EDO-TTF と支持電解質の TBA·BF₄を溶解したエタノールークロロベ ンゼン混合溶液 (1.5 mL, 9.5 mL) を入れ、約1週間、0.3 μ Aの定電流により電気化学的 酸化を行うことによって、黒色板状の結晶を得た。 κ -H₃(Cat-EDT-TTF)₂の場合には、電気 分解の際に、塩基として bipyridine を入れることで、カテコール部位の水酸基が脱プロト ン化され、水素結合ユニット構造を形成した[5]。一方で、 β '-1·BF₄の場合には、塩基を 加えた電気分解では結晶を得ることができず、電解溶液にエタノールを少量加えること で水素結合ユニットを形成した伝導体を合成することに成功した。これは、エタノール の高い極性、もしくはドナーH₂Cat-EDO-TTF に対してエタノールが僅かな塩基性として 働くことにより脱プロトン化が起こっていると考えられる。



[H₃(Cat-EDO-TTF)₂]BF₄

Scheme 2-1 水素結合ユニット型伝導体β'-1·BF₄の合成

得られた結晶について、シンクロトロン放射光 (KEK-PF, BL-8A) を用いて X 線構造解 析を行った。結晶学的データを Table 2-2 に示す。

	β'-1·BF 4(高温相)	α-1·BF 4(低温相)
Formula	$C_{24}H_{15}O_8S_8B_1F_4\\$	$C_{24}H_{15}O_8S_8B_1F_4\\$
Formula Weight	774.66	774.66
Crystal System	triclinic	triclinic
Space Group	<i>P</i> -1 (#2)	<i>P</i> -1 (#2)
Temperature / K	270	150
λ/Å	1.00000	1.00000
<i>a</i> / Å	7.2409(3)	7.1203(2)
b / Å	9.7683(5)	10.9390(4)
<i>c</i> / Å	10.8941(6)	18.0093(7)
lpha / °	66.6688(13)	78.1857(8)
eta / °	85.6578(18)	82.3285(10)
γ / °	79.0863(19)	89.7204(11)
$V/\text{\AA}^3$	695.62(6)	1358.06(8)
Z value	1	2
$d_{\rm calc}$ / g cm ⁻³	1.849	1.894
GOF	1.060	1.048
<i>R</i> 1 (I >2.00σ(I))	0.0435	0.0330
wR2 (All data)	0.1348	0.0958
# of observations	2452	3304
# of variables	232	473
CCDC	997839	997837

Table 2-2 β'-1·BF₄ (高温相、270 K) 及びα-1·BF₄ (低温相、150 K) の結晶学的データ

2-2-3 β'-1·BF₄(高温相)の結晶構造

まず初めに、水素結合ユニット型伝導体β'-1·BF4の高温相の水素結合ユニット構造を Fig. 2-5 に示す。中性の水素結合ユニットから構成されるκ-H₃(Cat-EDT-TTF)₂ (Fig. 2-1(a)-(c))との類似点は、今回得られた結晶β'-1·BF₄も、結晶学的に等価な 2 個の Cat-EDO-TTF 分子が対称的なアニオン性水素結合[O···H···O]⁻ (2.455(3) Å)で連結された 水素結合ユニット(1)を含んでいることである。異なる点は、H₃(Cat-EDT-TTF)₂のドナ 一分子間が二面角 ~ 84°の水素結合を形成したのに対して、今回合成された [H₃(Cat-EDO-TTF)₂]⁺では二面角~180°の水素結合を形成していることである。さらに、 位置的なディスオーダーを有する -1 価の BF4 アニオンを含んでいるため、全体の中性 を保つためにβ'-1·BF4 では TTF 骨格がより酸化されて、+1 価の水素結合ユニット [H₃(Cat-EDO-TTF)₂]⁺となっている。実際、X 線構造解析から求められた TTF 骨格の結合 長から見積もった結果、κ-H₃(Cat-EDT-TTF)₂では、Cat-EDT-TTFが+0.5価の酸化状態にあ るのに対して、[H₃(Cat-EDO-TTF)₂]⁺では、Cat-EDO-TTF は約+1.0 価の酸化状態であるこ とが示唆されている (Q" = +0.92(6), Table 2-3)。そのため、β'-1·BF₄の構成ユニットであ $[(EDO-TTF^+-Cat)-[O\cdots H\cdots O]^--(Cat-TTF^+-EDO)] \quad \forall t \quad [(EDT-TTF^{0.5+}-Cat)-[O\cdots H\cdots O]^-]$ ろ -(Cat-TTF^{0.5+}-EDT)]に比べてより大きな電気分極を水素結合ユニット内に有していること が予想される。



Fig. 2-5 β'-1·BF₄の 270 K における (a) 水素結合ユニットと位置的な乱れを有するアニ オン、および (b) 水素結合ユニットの長軸投影図

Table 2-3 β'-1・BF₄ (高温相)およびα-1・BF₄ (低温相)における TTF 骨格の結合長 (Fig. 2-6) からの電荷見積もり。κ-H₃(Cat-EDT-TTF)₂と同様に、BEDT-TTF 塩で適用される式か ら求めた電荷の値 Q、および Cat-TTF 塩での補正[5b] を行った電荷の値 Q'を計算した。 また、molecule A と B の電荷の合計が+2 となるように Q'の比を用いて Q"で規格化した。

			α-1· BF4	α-1· BF4	
	H ₂ Cat-EDO-11F	р´-1• ВF4	(molecule A)	(molecule B)	
a / Å	1.347(8)	1.386(3)	1.384(3)	1.382(3)	
b / Å	1.755(3), 1.755(3)	1.728(2), 1.714(3)	1.724(3), 1.726(3)	1.728(3), 1.725(3)	
b' / Å	1.770(3), 1.770(3)	1.722(3), 1.723(2)	1.723(3), 1.729(3)	1.729(3), 1.724(3)	
c / Å	1.760(4), 1.760(4)	1.740(3), 1.729(2)	1.734(3), 1.744(2)	1.734(2),1.736(3)	
c' / Å	1.756(4), 1.756(4)	1.722(3), 1.731(3)	1.724(3), 1.731(2)	1.728(3), 1.737(2)	
d / Å	1.394(6)	1.404(4)	1.411(4)	1.403(5)	
d' / Å	1.315(6)	1.338(5)	1.343(5)	1.336(5)	
δ^a / Å	0.774(6)	0.696(6)	0.669(6)	0.677(7)	
δ'^b / Å	0.864(6)	0.692(7)	0.727(7)	0.741(7)	
Q^c	0.235(6)	1.16(3)	1.140(3)	1.06(3)	
$\mathbf{Q}^{\prime d}$	0	0.92(6)	0.91(5)	0.82(5)	
Q'' ^e	_	_	1.05(5)	0.95(5)	

^{*a*} $\delta = b+c-a-d$, ^{*b*} $\delta' = b'+c'-a'-d'$, ^{*c*} $Q = 6.347-7.463 \cdot (\delta+\delta')/2$, ^{*d*} Q' = Q-0.235,

 ${}^{e}Q"(\text{molecule A or B}) = 2 \times \frac{Q^{'} \text{ (molecule A or B)}}{Q^{'} \text{ (moleculeA)} + Q^{'} \text{ (molecule B)}}$



Fig. 2-6 Cat-EDO-TTF における化学結合

EDT 基を EDO 基に置換したことによって引き起こされるこれらの構造的違いは、集積 構造に大きな違いを与えている。Fig. 2-7(a) に示すように、平面性の水素結合ユニットは BF₄ アニオンを含んでシート様の構造を形成しており、水素結合ユニット間には、EDO 基同士の S…O (3.032(2) Å) や O…O (3.025(3) Å) のコンタクトが見られた。また、ベンゼ ン環の水素と EDO 基の酸素は C-H…O型の水素結合 (C-(H)…O, 2.64(4) Å) を形成してい た。一方で、中性ドナーに見られた EDO 基同士の C-H…O型水素結合は見られなかった。 これは、EDO 基のエチレン部分が優先的に BF₄ アニオンと C-H…F コンタクトを形成し たためであると考えられる。このシート構造が積層することで、Cat-EDO-TTF⁺分子が 2 次元的な伝導層を形成したβ^{*}型[6] と呼ばれる分子配列を構築しており (Fig. 2-7(b))、 к-H₃(Cat-EDT-TTF)₂ とは異なる分子配列をしていた。Fig. 2-7(b) の黒い波線の円で示すよ うに、Cat-EDO-TTF⁺は分子平面間の距離 3.41 Å を有する head-to-tail 型 (Fig. 2-7(c)) で π ダイマー化しており、ダイマー間距離 3.60 Å よりとても短い。実際に、Table 2-4 に示す ように、計算された π ダイマー内の移動積分 (134 meV, Fig. 2-5(b)の相互作用 A) は、 π ダイマー間の移動積分 (4.3 meV, Fig. 2-5(b) の相互作用 B) より大きく、とても強い二量 化を起こしていることを示唆している。



Fig. 2-7 β'-1·BF₄の 270 K における分子配列 (a) bc 面, (b) 伝導層と(c) head-to-tail 型ダイ マー構造

Table 2-4 β'-1·BF₄ (高温相、270 K, Fig. 2-5(b)) およびα -1·BF₄ (低温相、150 K, Fig. 2-9(b))の伝導層における移動積分

		Р	-1°DF4 (同	11111月,2701	K)			
相互作用	А	В	С	D	E	-	-	-
移動積分/meV	134	4.3	51	0.13	0.08	-	-	-
	α-1·BF 4 (低温相, 150 K)							
相互作用	A'	Β'	C'	D'	E'	F'	G'	H'
移動積分 / meV	177	4	25.3	0.13	0.08	6.5	166	43.8

β'-1·BF4(高温相, 270 K)

今回のような+1 価に酸化された TTF⁺誘導体から構成される π 積層構造はとても珍し い。多くの場合において、強い分子間の Coulomb 反発のために、TTF⁺誘導体は孤立した π ダイマー構造や対アニオンとの交互積層を形成する[10, 11]。しかしながら、今回の系 においては、Fig. 2-5(a) に示すような分子内の大きな電気分極が、伝導キャリア間の Coulomb 斥力を軽減していると考えられる。さらに、双性イオン構造を有する Cat-EDO-TTF 骨格のダイマー間やダイマー内では、分子間の Coulomb 反発を有効的に減 少するように、 π 積層構造を構築している(Fig. 2-7(c))[4d]。

カラム間においても、いくつかの有効的な分子間相互作用を有している (Fig. 2-7(b),相 互作用 C-E)。特に、side-by-side のヘテロ原子間コンタクト (e.g. S…S: 3.575(1) Å)を含 む相互作用 C は、ダイマー内相互作用 A (134 meV) の次に大きな移動積分 (51 meV)を 有し (Table 2-4)、下記で議論するが、この系の物性に重要な役割を果たしている。

2-2-4 α-1·BF₄(低温相)の結晶構造

次に、150 K における低温相の結晶構造(Fig. 2-8(a), (b), Fig. 2-9(a), (b)) について、高 温相と比較しながら示す。興味深いことに、水素結合ユニットは、相転移の際に、水素 結合部の片側の酸素原子(O2)において屈曲し(Fig. 2-8(b),屈曲角度~147°)、その結果、 水素結合ユニットの非対称化が起こる。つまり、高温相において結晶学的に等価な2個 の Cat-EDO-TTF⁺骨格は、非等価となり(Fig. 2-8(a)の A, B 分子)、それと同時に、対称的 な水素結合[O…H…O]⁻も非対称化し、O-H, O…H 距離がそれぞれ 1.17(4) Å と 1.31(4) Å を持つ[O-H···O]⁻を形成する(Fig. 2-8(a), Fig. 2-9(a))[13]。結晶構造解析の結果を用い て、DFT 計算から水素結合部の水素原子を動かしたときのポテンシャルカーブを描くと、 高温相 (270 K) では 0.01 eV の浅い活性化障壁を有する対称的な二極小のポテンシャル を描いたのに対して、相転移後は水素結合部の非対称化に伴い、0.07 eVの差を持った非 対称なポテンシャルを描いた(Fig. 2-10)。しかしながら、TTF 結合長の解析によると、 低温相の TTF 骨格の価数は基本的に高温相と変わっておらず、+1 価の状態を維持してい ると計算された(+0.95(5), +1.05(5), Table 2-3) [13]。これは、DFT 計算によって、相転移前 後において、水素結合ユニットの HOMO の構造や電子密度に大きな変化がないこととも 一致する(Fig. 2-11)。また、BF₄アニオンも低温で熱振動は抑えられるものの、位置的な 乱れを残している(Fig. 2-8(a))。

ー方、伝導層内の Cat-EDO-TTF⁺の分子配列は劇的に変化していた。高温相で一種類の 同じ方向に傾いた π 積層からなる β ^{*}型配列 (Fig. 2-7(b))は、低温相で二種類の反対方向 に傾いた π 積層カラム (columns A, B)が交互に配列した α 型と呼ばれる分子配列 (Fig. 2-9(b)) へ相転移していた。この α -[H₃(Cat-EDO-TTF)₂]BF₄の結晶中において、カラム A と B の隣接した Cat-EDO-TTF⁺骨格の間の傾きは、水素結合ユニット内の屈曲角度に対応 している (Fig. 2-8(b))。このように、この特異な分子配列変化は水素結合ユニットの平面 構造と屈曲構造の間の変化を基盤としていることが示唆される。Table 2-4に示すように、 二つの相間の分子間移動積分を比較すると、ダイマー内相互作用(A, 134 meV)が低温相 においてより増加し(A^{*}, 177 meV と G^{*}, 166 meV)、一方で、カラム間相互作用(C, 51 meV) は低温相において大きく減少 (C^{*}, 25.3 meV)していることを示している。この結果は、 β ^{*}型と α 型の間での構造相転移はカラム内の $\pi - \pi$ 相互作用だけでなく、カラム間の相互 作用を大きく変化させ、電気的輸送特性や磁気的性質の顕著な変化を引き起こしたと考 えられる。

27



Fig. 2-8 α-1·BF₄の 150 K おける (a) 水素結合ユニット構造と位置的な乱れを有するア ニオン、および (b) 水素結合ユニットの分子長軸投影図



Fig. 2-9 α-1·BF₄の 150 K における (a) bc 面および (b) 伝導層の分子配列



Fig. 2-10 DFT 計算による (a) β'-1·BF₄ (270 K) と (b) α-1·BF₄ (150 K) における水素結合 ポテンシャルカーブ。



Fig. 2-11 DFT 計算 (B3LYP/6-31G(d)) による水素結合ユニットの HOMO (highest occupied molecular orbital)軌道 (a) β'-1・BF₄ (270 K), (b) α-1・BF₄ (150 K) および電子密度マップ (c) β'-1・BF₄ (270 K), (d) α-1・BF₄ (150 K)

2-2-5 1·BF₄のπ電子物性

1·BF4の電気抵抗(Fig. 2-12(a))と磁化率(Fig. 2-12(b))の温度依存性を、それぞれ単 結晶と多結晶を用いて測定した。両測定において、高温相β'-1·BF₄と低温相α-1·BF₄の間 の相転移に対応した異常がほとんど同じ温度領域において観測された(210-230K)。抵 抗率測定においては、急激な抵抗率の変化を伴う半導体-半導体転移が約 210 K で観測 され、高温相の135meVから低温相の165meVへ活性化エネルギーの増加が観測された。 この抵抗率の変化は、強い π ダイマー化の形成 [Table 2-4, (高温相) A = 134 meV → (低温 相) A' = 177 meV, G' = 166 meV] とカラム間相互作用の減少[Table 2-4, (高温相) C = 51 $meV \rightarrow (低温相) C' = 25.3 meV] のためであり、伝導性の \pi 電子がダイマー内に局在化し$ たためである。この異常は、転移幅が~4Kの小さなヒステリシスを伴っており、1次転 移であることを示唆している。+1 価ドナー分子である TTF⁺を基盤とした伝導体は珍しく、 例えば、[Bis(ethlenedithio)-TTF](FeBr₄)の伝導体は~10⁻⁶ S/cmと低い室温伝導度を与え る [10c, d]。しかし、この結晶は、+1 価のドナーが積層した伝導体の中でも比較的高い室 温伝導度 (σ_{r.t.} = 1/ρ_{r.t.} = 2×10⁻² S/cm) を有している。おそらく、この結果は Fig. 2-11(c) に 示すように、Cat-EDO-TTF⁺骨格の高い電子分極性により、伝導キャリア間の Coulomb 相 互作用が軽減していることや、Fig. 2-7(c)の様に、β'型の伝導層の Cat-EDO-TTF⁺と水素 結合 [O…H…O]- において分子間 Coulomb 反発を有効的に軽減する分子配置になってい ることに起因していると考えられる。



Fig. 2-12 1·BF₄の (a) 抵抗率の温度依存性と (b) 磁化率の温度依存性

また、磁気的性質も 220-230 K で大きく変化しており、 $\chi_M T$ 値は 300 K から徐々に減少 した後、230 K では急減し、220 K 以下では~ 0.0 emu mol⁻¹ K となり、低温相が非磁性状 態であることを示した (Fig. 2-12(b))。温度依存性も可逆的に観測されたが、磁化率測定 においては明確なヒステリシスは観測されなかった。300 K における $\chi_M T$ 値 (0.047 emu mol⁻¹ K) は 2 つの S = 1/2 のスピンのみの値 (0.75 emu mol⁻¹ K) よりとても小さく、 $\pi ダ$ イマー内において、カチオン性ラジカル S = 1/2 を持つ TTF⁺骨格間に強い反強磁性的相互 作用が働いていることが示唆される。

実際に、高温相の $\chi_M T$ の温度依存性(>230 K)は singlet-triplet dimer モデル[12]を用いて、反強磁性的交換相互作用 $2J/k_B = -1700$ K としてよく再現され(Fig. 2-12(b))、DFTの結果ともほぼ一致している(-1847.9 K, Table 2-5)。この強い反強磁性的相互作用は低温相への相転移によってさらに強くなり、非磁性状態となる[13]。それ故に、このシステムは相転移によって非磁性となることによってスピン系として安定化されると考えられる。つまり、非磁性状態の形成がこの系の相転換の要因であることが示唆される。上記に述べたように、非磁性状態は分子内 π - π 相互作用の増加によって引き起こされ、平面構造と屈曲構造の間での水素結合ユニットの構造転移に関与した Cat-EDO-TTF⁺骨格の分子配列の変化を起源としている。それ故に、今回の固相一固相相転換はユニット内水素結合の幾何学的自由度と、ユニット間の Cat-EDO-TTF⁺骨格の π ダイマー化の協同的な働きを媒介して起こっていると考えられる。

Table 2-5	DFT (B3LYP/6-310	G(d)) による	β'-1·BF ₄ (270	K, Fig.	2-3(a),	(b))、	および
α-1·BF ₄ (150) K, Fig. 2-6(a), (b))	における π	ダイマー間相互	互作用 2J	/k _B の計	算結果	Ę

		molecule A	molecule B
	β'-1·BF ₄ (270 K)	二量体(緑)	二量体(赤)
		α-1·BF ₄ (150 K)	α -1·BF ₄ (150 K)
$\langle S^2 \rangle_{BS}$	0.7647	0.72965	0.72956
$\langle S^2 \rangle_T$	2.0317	2.0340	2.0339
$E_{\rm BS}$ / hartree	-4709.7664	-4709.7703	-4709.7470
$E_{\rm T}$ / hartree	-4709.7627	-4709.7658	-4709.7427
$E_{\rm BS} - E_{\rm T} / {\rm K}$	-1170.6	-1395.4	-1366.5
$2Jk_{\rm B}^{-1}$ / K	-1847.9	-2139.5	-2095.3

2-3. 結論

第2章では新規な水素結合ユニット型伝導体β'-[H₃(Cat-EDO-TTF)₂]BF₄を作製し、特 異な固相-固相相転換を観測した。この相転換では、ユニット中心の水素結合部が平面 構造から屈曲構造へ幾何学的に変化することと連動して、伝導層内の Cat-EDO-TTF⁺骨格 の分子配列が、220 K 付近でβ'型からα型へと劇的に変化していることを、放射光を用い た室温および相転移以下 150 K での構造解析から明らかにした。さらに、この 210-230 K で、伝導性は低抵抗半導体から高抵抗半導体へ、また磁性も室温から大きな J=-1700 K の反強磁性相互作用をもつ常磁性から非磁性へ相転移することを見出した。このように、 2 つの相間における電子的輸送特性や磁気的性質、分子間相互作用の解析から、固相一固 相相転換がユニット内水素結合の幾何学的自由度を用いた約 30 度にも及ぶ大きな屈曲と、 ユニット間自由度に由来する Cat-EDO-TTF⁺骨格間の π ダイマー化によるスピンシングレ ット化の協同的働きによって媒介されていることを示唆している。この新規タイプの固 相一固相相転換は、水素結合された分子ユニットを基盤とした伝導体という特異な分子 性システム[5b-d]を基盤としており、水素結合自由度と π 電子物性が相関した特異な現 象だけでなく、その外場応答などの機能性物質としても興味深い。 実験

β'-1・BF4の合成

新規結晶β'-1・BF₄は、H型セルの片側に H₂Cat-EDO-TTF (3.0 mg, 8.7 mmol)、両側に支 持電解質となる *n*-Bu₄N・BF₄ (5.7 mg, 17.4 mmol) をドナー分子に対して2当量ずつ加えて、 アルゴン置換した。脱水エタノール 1.5 mL とクロロベンゼン 9.5 mL を加えた後、白金電 極を H 字管の両側に挿入し、溶液に定電流 (~0.3µA) をかけることによって約1週間で 黒色板状の結晶を得た (~0.2 mg)。

X 線構造解析

高エネルギー加速器研究所 BL8A の放射光を用いて行った。X 線のエネルギーは 12.4 keV (X 線の波長 λ = 1.0 Å)を使用し、振動写真法により回折点を IP(イメージングプレート、 Rigaku)で収集した。測定および回折データの処理は Rigaku Rapid AUTO(Rigaku)を使用し た。冷却は He ガスの吹付けにより行い、PID 制御により温度制御を行った。結晶構造につい ては結晶構造解析プログラムである Crystal Structure ver. 4.1(Rigaku)を用いて直接法から求 め、最小二乗法により精密化した。 β '-1·BF₄のエチレンジオキシ基の水素は計算によって求 めてから、最適化を行った。

電気抵抗率測定

β'-1・BF₄の単結晶を用いて、マルチチャンネル交流4端子伝導度計 HECS 994C型(扶桑 製作所)による4端子測定を行った。金線(25 μm φ)と試料の接合にはカーボンペースト (Dotite XC-12, JEOL)を用いた。

磁化率測定

SQUID (超伝導量子干渉素子) 磁気特性測定システム (MPMS) (Quantum Design) を用いて、 静磁化率測定を行った。それぞれ、 β '-1・BF₄の多結晶~3.0 mg を用いて、磁場1T下におい て 2-300 K の温度範囲で測定した。静磁化率は、パスカル反磁性で補正した。

理論計算

DFT は結晶構造解析で求めた座標を基に、Gaussian 03(B3LYP/6-31G(d))を用いて計算を 行った。移動積分は、結晶構造解析で得られた座標を用いて拡張 Hückel 法で分子軌道を計算 し、分子軌道間の重なり積分に 10 eV を乗算して求めた[9]。
参考文献

- (a) T. Ishiguro, K. Yamaji and G. Saito, Organic Superconductors, Springer-Verlag, Berlin, 2nd edn., 1998; (b) Molecular Switches, ed. B. L. Feringa, Wiley-VCH, Weinheim, Germany, 2001; (c) Magnetism: Molecules to Materials, ed. J. S. Miller and M. Drillon, Wiley-VCH, Weinheim, Germany, Vol. I-V, 2001-2005; (d) Special issue on Molecular Conductors: Chem. Rev. 2004, 104, 4887-5782; (e) J. J. Vittal, Coord. Chem. Rev. 2007, 251, 1781; (f) H. Mori, Introduction of Organic Superconducting Materials, in Introduction to Organic Electronic and Optoelectronic Materials and Devices, ed. S. S. Sun and L.R. Dalton, CRC press, Orlando, 2008, pp. 263-286; (g) Special issue on Molecular Conductors: Crystals 2012, 2, 43-1513; (h) Special issue on Molecular Conductors: Eur. J. Inorg. Chem. 2014, 2014, 3780-4038
- [2] (a) T. M. Barclay, A. W. Cordes, N. A. George, R. C. Haddon, M. E. Itkis, M. S. Mashuta, R. T. Oakley, G. W. Patenaude, R. W. Reed, J. F. Richardson and H. Zhang, J. Am. Chem. Soc. 1998, 120, 352; (b) W. Fujita and K. Awaga, Science 1999, 286, 261; (c) G. D. McManus, J. M. Rawson, N. Feeder, J. van Duijn, E. J. L. McInnes, J. J. Novoa, R. Burriel, F. Palacio and P. Oliete, J. Mater. Chem. 2001, 11, 1992; (d) W. Fujita, K. Awaga, H. Matsuzaki and H. Okamoto, Phys. Rev. B 2002, 65, 064434; (e) J. L. Brusso, O. P. Clements, R. C. Haddon, M. E. Itkis, A. A. Leitch, R. T. Oakley, R. W. Reed and J. F. Richardson, J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, 8256; f) J. L. Brusso, O. P. Clements, R. C. Haddon, M. E. Itkis, A. W. Reed and J. F. Richardson, J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, 8256; f) J. L. Brusso, O. P. Clements, R. C. Haddon, M. E. Itkis, A. M. Reed and J. F. Richardson, J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, 8256; f) J. L. Brusso, O. P. Clements, R. C. Haddon, M. E. Itkis, A. A. Leitch, R. T. Oakley, R. W. Reed and J. F. Richardson, J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, 8256; f) J. L. Brusso, O. P. Clements, R. C. Haddon, M. E. Itkis, A. A. Leitch, R. T. Oakley, R. W. Reed and J. F. Richardson, J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, 8256; f) J. L. Brusso, O. P. Clements, R. C. Haddon, M. E. Itkis, A. A. Leitch, R. T. Oakley, R. W. Reed and J. F. Richardson, J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, 14692.
- [3] (a) H. H. Wang, K. D. Carlson, L. K. Montgomery, J. A. Schlueter, C. S. Cariss, W. K. Kwok, U. Geiser, G. W. Crabtree and J. M. Williams, *Solid State Commun.* 1988, 66, 1113; (b) E. Laukhina, J. Vidal-Gancedo, V. Laukhin, J. Veciana, I. Chuev, V. Tkacheva, K. Wurst and C. Rovira, *J. Am. Chem. Soc.* 2003, 125, 3948; (c) S. A. Baudron, P. Batail, C. Coulon, R. Clérac, E. Canadell, V. Laukhin, R. Melzi, P. Wzietek, D. Jérome, P. Auban-Senzier and S. Ravy, *J. Am. Chem. Soc.* 2005, 127, 11785; (d) Z. Ni, X. Ren, J. Ma, J. Xie, C. Ni, Z. Chen and Q. Meng, *J. Am. Chem. Soc.* 2006, 128, 14649; (f) T. Shirahata, K. Shiratori, S. Kumeta, T. Kawamoto, T. Ishikawa, S. Koshihara, Y. Nakano, H. Yamochi, Y. Misaki and T. Mori, *J. Am. Chem. Soc.* 2012, 134, 13330.

- [4] (a) T. Murata, Y. Morita, K. Fukui, K. Sato, D. Shiomi, T. Takui, M. Maesato, H. Yamochi, G. Saito and K. Nakasuji, *Angew. Chem. Int. Ed.* 2004, 43, 6343; (b) T. Murata, Y. Morita, Y. Yakiyama, K. Fukui, H. Yamochi, G. Saito and K. Nakasuji, *J. Am. Chem. Soc.* 2007, 129, 10837; (c) Y. Kobayashi, M. Yoshioka, K. Saigo, D. Hashizume and T. Ogura, *J. Am. Chem. Soc.* 2009, 131, 9995; (d) A. El-Ghayoury, C. Mézière, S. Simonov, L. Zorina, M. Cobián, E. Canadell, C. Rovira, B. Náfrádi, B. Sipos, L. Forró and P. Batail, *Chem. Eur. J.* 2010, 16, 14051. See also a review and an account, (e) M. Fourmigué and P. Batail, *Chem. Rev.* 2004, 104, 5379; (f) Y. Morita, T. Murata and K. Nakasuji, *Bull. Chem. Soc. Jpn.* 2013, 86, 183.
- [5] (a) H. Kamo, A. Ueda, T. Isono, K. Takahashi and H. Mori, *Tetrahedron Lett.* 2012, 53, 4385;
 (b) T. Isono, H. Kamo, A. Ueda, K. Takahashi, A. Nakao, R. Kumai, H. Nakao, K. Kobayashi, Y. Murakami and H. Mori, *Nat. Commun.* 2013, 4, 1344; (c) T. Isono, H. Kamo, A. Ueda, K. Takahashi, M. Kimata, H. Tajima, S. Tsuchiya, T. Terashima, S. Uji and H. Mori, *Phys. Rev. Lett.* 2014, 112, 177201; (d) A. Ueda, S. Yamada, T. Isono, H. Kamo, R. Kumai, H. Nakao, Y. Murakami, K. Yamamoto, Y. Nishio and H. Mori, *J. Am. Chem. Soc.* 2014, 136, 12184; (e) A. Ueda, A. Hatakeyama, M. Enomoto, R. Kumai, Y. Murakami, and H. Mori, *Chem. A Eur. J.*, 2015, 21, 15020.
- [6] (a) T. Mori, Bull. Chem. Soc. Jpn. 1998, 71, 2509; (b) T. Mori, H. Mori and S. Tanaka, Bull.
 Chem. Soc. Jpn. 1999, 72, 179; (c) T. Mori, Bull. Chem. Soc. Jpn. 1999, 72, 2011.
- [7] S. Horiuchi, H. Yamochi, G. Saito, K. Sakaguchi, and M. Kusunoki, J. Am. Chem. Soc., 1996, 118, 8604.
- [8] For representative examples of single component purely organic conductors (σ_{r.t.} = 10⁻²-10⁻¹ S/cm), (a) A. W. Cordes, R. C. Haddon, R. T. Oakley, L. F. Schneemeyer, J. V. Waszczak, K. M. Young and N. M. Zimmerman, *J. Am. Chem. Soc.* 1991, **113**, 582; (b) O. Neilands, V. Tilika, I. Sudmale, I. Grigorjeva, A. Edzina, E. Fonavs and I. Muzikante, *Adv. Mater. Opt. Electron.* 1997, **7**, 39; (c) X. Chi, M. E. Itkis, B. O. Patrick, T. M. Barclay, R. W. Reed, R. T. Oakley, A. W. Cordes and R. C. Haddon, *J. Am. Chem. Soc.* 1999, **121**, 10395; (d) M. E. Itkis, X. Chi, A. W. Cordes and R. C. Haddon, *Science* 2002, **296**, 1443.
- [9] T. Mori, A. Kobayashi, Y. Sasaki, H. Kobayashi, G. Saito, H. Inokuchi, Bull. Chem. Soc. Jpn. 1984, 57, 627.
- [10] (a) J. B. Torrance, B. A. Scott, B. Welber, F. B. Kaufman and P. E. Seiden, Phys. Rev. B 1979,

19, 730; (b) U. Geiser, M. A. Beno, A. M. Kini, H. H. Wang, A. J. Schultz, B. D. Gates, C. S. Cariss, K. Douglas Carlson and J. M. Williams, *Synth. Met.* 1988, 27, A235; (c) T. Mallah, C. Hollis, S. Bott, M. Kurmoo, P. Day, M. Allan and R. H. Friend, *J. Chem. Soc. Dalton. Trans.* 1990, 859; (d) A. Guirauden, I. Johannsen, P. Batail and C. Coulon, *Inorg. Chem.* 1993, 32, 2446.

- [11] (a) H. Kobayashi, R. Kato, A. Kobayashi and Y. Sasaki, *Chem. Lett.* 1985, 14, 191; (b) O. Jeannin and M. Fourmigué, *Inorg. Chim. Acta.* 2007, 360, 3820.
- [12] B. Bleaney and K. D. Bowers, Proc. R. Soc. London, Ser. A 1952, 214, 451.
- [13] J. Yoshida, A. Ueda, A. Nakao, R. Kumai, H. Nakao, Y. Murakami, and H. Mori, *Chem. Commun.*, 2014, 55, 15557.

第3章 動的水素結合自由度が相関したπ電子物性スイッチング現象の系統的研究:アニオン置換による化学圧力効果

3-1. 導入

分子性有機導体は、超伝導相、金属相、絶縁相をはじめとする多彩な電子状態をとる ことが知られており、さらにこれらは温度や圧力、磁場などの外部刺激に敏感であるこ とから、固体化学、物性物理学の基礎的観点からだけでなく、機能性物質科学や材料科 学などの応用的観点まで幅広く注目されている。中でも、分子性有機導体に対する圧力 効果は、電子状態を解明、制御する方法として重要である[1]。

有機導体における化学圧力は、ドナー分子の化学修飾[2] や対アニオン体積[3] の違い として知られている。例えば、(MeEDO-TTF)₂X (X = BF₄, ClO₄, PF₆) は、いずれも同型構 造を有しており、アニオン体積の変化によって分子間の相互作用を有効に変調できるこ とが報告されている[3d]。アニオン体積 V_A が小さな X = BF₄ (V_A = 89.5 Å³), ClO₄ (V_A = 97.5 Å³) では低温まで金属相が安定であるのに対して、アニオン体積のより大きな X = PF₆ (V_A = 112.8 Å³) では、半導体的挙動を示す。これは、アニオンの体積増加に起因した負の化 学圧力効果によって、ドナー分子間相互作用が減少し、金属相が不安定化した結果であ る。さらに、アニオン置換によるわずかな格子の歪みはドナー分子間の電荷不均化を促 し、半導体-半導体転移を起こす。このように、アニオン置換を利用した化学圧力効果は π 電子物性を制御、理解するのに重要な方法である。しかしながら、TTF 基盤の有機導 体は対アニオンのサイズと分子配列にある程度の相関を有しており、幅広いアニオンサ イズ変化や対称性の異なるアニオン置換によって可型結晶を得るのは難しい[4]。事実、 (MeEDO-TTF)₂X において、X = PF₆は合成条件によって 3 種類の多形をとり、さらに大き なアニオン(AsF₆, SbF₆, NbF₆, etc.) では、良質の単結晶を合成できていない[3d]。

第2章では、新規な水素結合ユニット型伝導体β'-[H₃(Cat-EDO-TTF)₂]BF₄(β '-1·BF₄) を合成することに成功し、水素結合部の動的な幾何学的自由度と伝導性や磁性が相関し た π 電子物性のスイッチング現象を見出した[5]。この伝導体では、TTF 骨格が+0.5 価の 中性の水素結合ユニット型伝導体 κ -H₃(Cat-EDT-TTF)₂と比べて、TTF 骨格が+1 価である ことによって結晶中に 4 面体アニオンの BF₄を含んでいる。本研究では、特異な電荷状 態を持つ新奇タイプの水素結合ユニット型有機伝導体の研究を発展させることを目的と して、アニオン置換による化学圧力効果に着目して、BF₄アニオンを 4 面体の ClO₄アニ オンと 8 面体の PF₆アニオン, AsF₆アニオンに置換したβ'-[H₃(Cat-EDO-TTF)₂]X (X = ClO₄, PF₆, AsF₆: β '-1·X) の合成を行った。その結果、すべてのアニオン置換体において β '-1·BF₄ (高温相) と同型構造の結晶を得ることに成功した。これらの伝導体の物性測定と結晶構 造解析の結果から、化学圧力効果による異方的なドナー間の分子間相互作用の変調が見 られた。興味深いことに、BF₄ アニオンと同対称性の ClO₄ アニオン置換体では、わずか な体積変化にも関わらず、 β '-1·BF₄で見られた構造相転移が見られなかった。上記に示し たように、3 章では、 β '-1·BF₄の水素結合部の動的な幾何学的自由と伝導性、磁性が相関 したスイッチング現象を、アニオン置換によるわずかな格子変調が与える化学圧力効果 によって制御することに成功し、その機構解明について知見を得たので述べる。

3-2. 結果と考察

3-2-1 アニオン置換した水素結合ユニット型伝導体 β'-[H₃(Cat-EDO-TTF)₂]X(β'-1·X: X = ClO₄, PF₆, AsF₆)の合成

新規アニオン置換体**β'-1·X** (X = ClO₄, PF₆, AsF₆) は、**β'-1·BF**₄ (2 章) と同様の電気化学 的方法によって合成した。以下に合成 Scheme 3-1 を示す。クロロベンゼンとエタノール (19:3) の混合溶媒中に、ドナー分子の H₂Cat-EDO-TTF と支持電解質の *n*-Bu₄N·X (X = ClO₄, PF₆, AsF₆) を溶解させ、約1週間、0.3 μ A の定電流により電気化学的酸化を行うこ とによって[H₃(Cat-EDO-TTF)₂]X (X = ClO₄, PF₆, AsF₆) を黒色板状の結晶として得た。 **β'-1·BF**₄ と同様に、エタノールがカテコール部の水酸基の脱プロトン化を促していると考 えられる。



 $[H_3(Cat-EDO-TTF)_2]X (X = ClO_4, PF_6, AsF_6)$

Scheme 3-1 水素結合ユニット型伝導体β'-1·X (X = ClO₄, PF₆, AsF₆) の合成

3-2-2 β'-1·X (X = ClO₄, PF₆, AsF₆)の結晶構造

β'-1・X (X = ClO₄, PF₆, AsF₆)の結晶構造解析は高エネルギー加速器研究所 PF-BL8A のシ ンクロトロン放射光(λ=1.0Å) を用いて行った。Table 3-1 に結晶学的データを示す。 β'-1·X (X = ClO₄, PF₆, AsF₆) は、空間群 P-1 であり、β'-1·BF₄ (高温相) と同型構造であり、 Cat-EDO-TTF分子同士が二面角~180°の脱プロトン型水素結合[O···H···O]⁻で連結された 水素結合ユニットと1分子のアニオンXを結晶中に含んでいた(Fig. 3-1 (a), (b), (d), (e), (g), (h), (i), (k))。アニオン分子の中心には対称心が存在しており、BF4アニオンと同様の四面 体構造である CIO₄ アニオンでは、位置的および熱的ディスオーダー構造を有している (Fig. 3-1, (c), (f), (i), (l))。β'-1·BF₄の水素結合ユニット構造と同様に水素結合の酸素間の 中心に対称心が存在しており、2つの Cat-EDOTTF 分子は結晶学的に等価である。水素結 合距離(酸素間距離 O···O)は、β'-1·BF₄(高温相)で 2.455(3) Å であったのに対して、 β'-1·ClO₄では 2.456(4) Å, 1·PF₆では, 2.465(3) Å, 1·AsF₆では 2.460(5) Å であり、アニオン の体積によらず同程度の結合距離を有していることが分かった(Fig. 3-1, (a), (d), (g), (j))。 TTF 骨格の結合長からドナー分子の電荷状態を見積もったところ(Table 3-2)、β'-1·BF₄ (+0.92(5)) と同様に、**β'-1·X**(X = ClO₄(+0.96(5), PF₆(+0.95(9), AsF₆(+0.92(6)) における水素 結合ユニット中のドナー分子は~+1の酸化状態であることが分かった。つまり、β'-1·BF4 と同様の電荷状態を持つカチオン性水素結合ユニット[H₃(Cat-EDO-TTF)₂]⁺を形成してい る。

Fig. 3-3 に示すように、水素結合ユニット構造と対アニオンの間には、アニオンの立体 構造の違いを反映した原子間コンタクトの違いが見られた。4 面体アニオン BF4, ClO4 で は、vdW 和より短い原子間コンタクトを3 方向に形成しているのに対して、8 面体アニ オン PF6, AsF6 では、4 方向に形成している。4 面体アニオンの熱温度因子に比べて、8 面 体アニオンは小さな熱温度因子を有しており、アニオンの立体構造またはサイズ増大に よる原子間コンタクトの増加に起因して熱運動が抑えられていると考えられる。

40





Fig. 3-1 β'-1·X [(a)-(c); X = BF₄(270 K) [5], (d)-(f); X = ClO₄(298 K), (g)-(i); X = PF₆(270 K), (g)-(i); X = AsF₆(270 K)] の水素結合ユニット構造とアニオン構造

	β'-1·ClO ₄	β'-1·PF ₆	β'-1·AsF ₆	β' -1·BF ₄ [3]
Formula	$C_{24}H_{15}ClO_{12}S_8$	$C_{24}H_{15}F_6O_8PS_8\\$	$C_{24}H_{15}AsF_6O_8S_8$	$C_{24}H_{15}O_8S_8B_1F_4\\$
Formula weight	787.31	832.86	876.77	774.66
Crystal System	triclinic	triclinic	triclinic	triclinic
Space Group	P-1 (#2)	<i>P</i> -1 (#2)	<i>P</i> -1 (#2)	<i>P</i> -1 (#2)
<i>a</i> / Å	7.2808(4)	7.2482(2)	7.2247(5)	7.2409(3)
b / Å	9.8586(8)	10.2680(3)	10.4855(9)	9.7683(5)
<i>c</i> / Å	10.8660(8)	10.8587(7)	10.8336(9)	10.8941(6)
lpha / °	66.382(2)	65.373(1)	64.610(2)	66.6688(13)
eta / °	85.050(3)	85.602(2)	85.799(3)	85.6578(18)
$\gamma/$ °	78.872(3)	79.458(2)	79.794(3)	79.0863(19)
$V/\text{\AA}^3$	701.15(9)	722.24(6)	729.69(10)	695.62(6)
Z value	1	1	1	1
Temperature / K	298	270	270	270
$d_{\rm calc}$ / g·cm ⁻³	1.864	1.910	1.995	1.849
λ / Å	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
# of observations	2159	2554	1824	2452
# of variables	236	227	227	232
$R_1 (I > 2.0\sigma(I))$	0.0455	0.0546	0.0405	0.0435
wR_2 (all data)	0.1375	0.1478	0.1127	0.1348
GOF	1.097	1.067	1.013	1.060

Table 3-1 β'-1·X (X = BF₄[5], ClO₄, PF₆, AsF₆)の結晶学的データ

	01 1 CIO	Q' 1.DE Q' 1.AsE		β' -1·B F ₄	H ₂ Cat-EDO-TTF
	β ² -1•ClO ₄	p [*] -1•PF ₆	þ´-1•Asf ₆	(高温相)[5]	[5]
a / Å	1.383(3)	1.383(4)	1.387(5)	1.386(3)	1.347(8)
b/Å	1.729(2)	1.727(2)	1.724(4)	1.728(2)	1.755(3)
	1.715(3)	1.721(3)	1.720(5)	1.714(3)	1.755(3)
b' / Å	1.717(3)	1.724(2)	1.719(4)	1.722(3)	1.770(3)
	1.711(2)	1.722(3)	1.720(5)	1.723(2)	1.770(3)
c / Å	1.740(3)	1.744(3)	1.738(4)	1.740(3)	1.760(4)
	1.730(2)	1.729(2)	1.733(3)	1.729(2)	1.760(4)
c' / Å	1.722(3)	1.730(3)	1.727(3)	1.722(3)	1.756(4)
	1.724(3)	1.719(2)	1.729(4)	1.731(3)	1.756(4)
d / Å	1.407(4)	1.408(4)	1.399(7)	1.404(4)	1.394(6)
d' / Å	1.340(5)	1.350(4)	1.341(7)	1.338(5)	1.315(6)
δ^a / Å	0.701(6)	0.699(8)	0.70(1)	0.696(6)	0.774(6)
$\delta^{\prime b}$ / Å	0.681(6)	0.686(6)	0.69(1)	0.692(7)	0.864(6)
Q^c	1.19(3)	1.18(3)	1.16(5)	1.16(3)	0.24(3)
Q'^d	0.96(5)	0.95(5)	0.92(6)	0.92(5)	0

Table 3-2 β'-1·X (X = BF₄[5], ClO₄, PF₆, AsF₆) における TTF 骨格の結合長からの電荷見積 もり。κ-H₃(Cat-EDT-TTF)₂ と同様に、BEDT-TTF 塩で適用される式[6] から求めた電荷の 値 Q、および Cat-TTF 塩での補正[8] を行った荷の値 Q'を計算した。

^{*a*} $\delta = b + c - a - d$, ^{*b*} $\delta' = b' + c' - a' - d'$, ^{*c*} $Q = 6.347 - 7.463 \cdot (\delta + \delta')/2$, ^{*d*} Q' = Q - 0.235



Fig. 3-2 Cat-EDO-TTF の化学結合.



Fig. 3-3 β'-1·X (X = (a) BF₄[5] (270 K), (b) ClO₄ (298 K), (c) PF₆ (270 K), (d) AsF₆ (270 K))の 水素結合ユニットとアニオンの vdW 和より短い原子間距離

Fig. 3-4 に示すように、 β '-1·X (X = ClO₄, PF₆, AsF₆) は、 β '-1·BF₄の高温相と同じ分子配 列様式を形成しており、ab 面に伝導層が存在している。つまり、水素結合ユニットの片 側ドナー分子同士からなるダイマー構造 (Fig. 3-4(b)) が、a 軸方向に π 積層しており、 bc 面でドナー分子同士は side-by-side の相互作用で繋がっている。ダイマー内には S…S コンタクトと C…S コンタクトが存在し、それぞれのアニオン置換体のダイマー内距離は、 ~ 3.41 Å と大きな変化は見られない (Fig. 3-5, Table 3-3)。すべての結晶において、強いダ イマー構造を形成している。一方で、ダイマー間距離はアニオン体積の増加に伴って 3.60 Å (β '-1·BF₄, 270 K) から 3.52 Å (β '-1·AsF₆, 270 K) と短くなっていることが分かった (Table 3-3)。



Fig 3-4 β'-1・ClO₄ (270 K) の(a) bc 面から見た水素結合ユニット配列, (b) 水素結合ユニ ットの重なり, (c) 伝導層内の分子配列 (点線はダイマー構造を表す)



Fig. 3-5 ダイマー内の原子間接触

	β' -1·B F ₄	β'-1·ClO ₄	β' -1· PF ₆	β'-1·AsF ₆
	(270 K) [5]	(298 K)	(270 K)	(270 K)
S····S /Å	3.451(1)	3.472(1)	3.461(1)	3.456(2)
C····S /Å	3.473(4)	3.472(4)	3.423(4)	3.407(5)
Intradimer distance /Å	3.41	3.41	3.41	3.41
Interdimer distance /Å	3.60	3.59	3.54	3.52

Table 3-3 β'-1·X (X = BF₄, ClO₄, PF₆, AsF₆) のダイマー内の原子間距離

3-2-3 β'-1·X (X = ClO₄, PF₆, AsF₆)のπ電子物性

β'-1・X (X = BF₄, ClO₄, PF₆, AsF₆)のアニオン置換効果を調査するために電気伝導度や磁 化率の測定を行ったところ、以下に示すように、化学圧力効果がこれらのπ電子物性に 重要な変化を与えていることが分かった。Fig. 3-6 に 1·X (X = BF₄, ClO₄, PF₆, AsF₆)の抵抗 率の温度依存性を示す。抵抗率測定は、板状結晶の長軸方向である分子積層方向(*a* 軸) について4端子法を用いて行った。前章で報告したβ'-1・BF₄ (高温相)は、室温抵抗率 50 Ω ·cm と活性化エネルギー135 meV の半導体的挙動を示し、約 210 K 付近で、ヒステリシ スを伴った半導体ー半導体転移を起こす。今回合成したβ'-1·X (X = ClO₄, PF₆, AsF₆)は全 て半導体的挙動を示し、それぞれの活性化エネルギーはそれぞれ 124 meV (β'-1・ClO₄), 186 meV (β'-1・PF₆), 189 meV (β'-1・AsF₆)であった。また、室温抵抗率は 100 Ω·cm (β'-1・ClO₄), 180 meV (β'-1・PF₆), 1700 Ω·cm (β'-1・AsF₆)とアニオン体積の増加に伴い 1 桁から 2 桁近 く増加することが分かり、結晶内に化学圧力効果が働いていることが示唆された。また 興味深いことに、1・BF₄で見られた、構造相転移挙動(β'型からα型へのドナー配列変化) に由来する伝導度の異常は、今回の測定範囲においてβ'-1・X (X = ClO₄, PF₆, AsF₆)では見 られなかった。



Fig. 3-6 1·X (X = BF₄[5], ClO₄, PF₆, AsF₆)の抵抗率温度依存性

Table 3-4 β'-1·X (X = BF₄, ClO₄, PF₆, AsF₆)の室温電気抵抗率と活性化エネルギー

	β'-1·BF ₄ [5]	β' -1· ClO ₄	β' -1· PF ₆	β'-1·AsF ₆
$ ho_{ m R.T.}$ / Ω ·cm	50	100	1500	1700
$E_{\rm a}$ / meV	135	124	186	189

次に、多結晶のサンプルを用いて磁化率測定を 2-300K の範囲で行った結果を Fig. 3-7 に示す。 β '-1·X (X = ClO₄, PF₆, AsF₆) は室温において小さな_{*XM}T* 値 0.03 ~ 0.08 emu·K/mol を示し、温度低下とともに_{*XMT*} ~ 0 emu·K/mol となったことから、 β '-1·BF₄ と同様に強い ダイマー性を有していると考えられ、構造解析の結果と一致する (Fig. 3-5, Table 3-3)。そ こで、Singlet-Triplet dimer モデル[8] を用いてフィッティングを行ったところ、2*J*/*k*_B ~ -1500 ~ -1800 K の強い反強磁性的相互作用が示唆された。これらの値は、Table 3-5 に示 したように、DFT 計算から得られたダイマー内の相互作用 (β '-1·ClO₄ = -1765 K, β '-1·PF₆ = -1996 K, β '-1·AsF₆ = -1925 K) の計算結果ともほぼ一致している。 β '-1·ClO₄ は小さな値 を有していることから、ダイマー内の反強磁性相互作用が 4 つの塩の中でも弱いと考え られる。磁化率測定においても伝導度測定と同様に、1·BF₄に見られる磁化率の異常は観 測されなかった。</sub>

以上の結果から、 β' -1·X (X = BF₄, ClO₄, PF₆, AsF₆) では、アニオン置換によって大きく 室温抵抗率が異なっており、系内に化学圧力効果が働いていることが示唆された。さら に、 β' -1·X (X = ClO₄, PF₆, AsF₆) が β' -1·BF₄ と同形構造であるにもかかわらず、水素結合 ユニットの屈曲を伴った構造相転移現象 (2章) が見られなかったことはとても興味深い 結果である。そこで、アニオン置換が結晶構造へ与える変調効果を調べることで、化学 圧力と電子物性や相転移のメカニズムの関係性について考察した。



Fig. 3-7 1·X (X = (a) BF₄[5], (b) ClO₄, (c) PF₆, (d) AsF₆)の磁化率温度依存性

Compound	β'-1·ClO ₄	β'-1·PF ₆	β'-1·AsF ₆	β'-1·BF₄
	(298 K)	(270 K)	(270 K)	(270 K) [5]
$\langle S^2 \rangle_{\rm BS}$	0.7784	0.7329	0.7512	0.7647
$\langle S^2 \rangle_{\rm T}$	2.0307	2.0301	2.0309	2.0317
$E_{\rm BS}$ / hartree	-4709.7979	-4709.8913	-4709.8871	-4709.7664
$E_{\rm T}$ / hartree	-4709.7944	-4709.8872	-4709.8832	-4709.7627
$E_{\rm BS} - E_{\rm T} / {\rm K}$	-1105.2	-1294.7	-1231.5	-1170.6
$2Jk_{\mathrm{B}}^{-1}$ / K	-1765.1	-1996.1	-1924.7	-1847.9

Table 3-5 DFT (B3LYP/6-31G(d)) による π ダイマー間相互作用 2J/k_Bの計算結果

3-2-4 アニオン置換による異方的化学圧力効果の考察とπ電子物性との相間

アニオン置換がπ電子物性に与える影響を考察するために、それぞれの結晶構造パラ メーターを比較した。Fig. 3-8(a) に示したように、アニオン体積の増加に伴って単位胞体 積は増加し (β'-1・BF₄: 695.62(6) Å³ → β'-1・ClO₄: 701.15(9) Å³→ β'-1・PF₆: 722.24(6) Å³ → β'-1・AsF₆: 729.69(10) Å³)、同時に *b* 軸も伸長していることが分かる。一方で、*a*, *c* 軸は、 ほとんど変化がない。つまり、アニオン体積の増加に伴う負の化学圧力効果は *b* 軸方向 の構造変化と関連していると考えられる。また、伝導層 (*ab* 面) が *b* 軸を含むことから、 負の化学圧力によって室温抵抗率が増加していることも一致している。



Fig. 3-8 アニオン置換による単位胞体積変化に対する (a) 格子定数の変化と (b) β'-1・BF₄を基準とした各変化の割合

そこで、*b*軸方向の構造変化が分子間相互作用に与える影響について調べるために、 β '-1·X (X = BF₄, ClO₄, PF₆, AsF₆)の伝導層内の各移動積分を計算した (Fig. 3-9, Table 3-6)。 その結果、アニオン体積の増加に伴って、*b*軸方向を含む相互作用 C や相互作用 D が減 少していることが分かった。中でも、相互作用 C では、 β '-1·BF₄ (51 meV) $\rightarrow \beta$ '-1·ClO₄ (41 meV) $\rightarrow \beta$ '-1·PF₆ (20 meV) $\rightarrow \beta$ '-1·AsF₆ (13 meV) となり、アニオン体積に相関 した大きな減少が見られた。これは、Table 3-7 に見られるように、相互作用 C を形成す るドナー間 side-by-side 方向の①S···S コンタクト距離(Fig. 3-9(b))が *b*軸の増加に伴って 伸長していることと一致している (β '-1·BF₄ : 3.575(1) Å $\rightarrow \beta$ '-1·ClO₄ : 3.661(1) Å $\rightarrow \beta$ '-1·PF₆ : 3.947(3) Å $\rightarrow \beta$ '-1·AsF₆ : 4.128(2) Å)。それ故に、対アニオンの体積増加は、異 方的な化学圧力効果として伝導層内のダイマー間相互作用 C (Fig. 3-9(b))を主に減少さ せており、結果として、室温抵抗率が増加していると考えられる。相互作用 D (Fig. 3-9(c)) では、対アニオンの体積増加によって、②C(H)…O 距離 (Fig. 3-9(c)②) は 3.481(4) Å から 3.375 (7) Å とわずかに短くなっているが、③C(H)…S 距離 (Fig. 3-9(c)) が 3.737(4) Å から 4.194(6) Å と伸長しており、結果として僅かな相互作用の減少が見られたと考えられる。 また、伝導層内の相互作用ではないが、Fig. 3-9(c) に示す④S…O コンタクト(Fig. 3-9(c)) や⑤O…O コンタクト (Fig. 3-9(c)) もアニオン体積の増加に伴って 3.032(2) Å から 3.052(4) Å、3.025(3) Å から 3.094(7) Å とそれぞれ伸長しており、b 軸方向への負の化学圧 力効果が見られる。一方で、a 軸方向のダイマー内相互作用 A やダイマー間相互作用 B では、アニオン体積に依存性は見られない (Fig. 3-8(b))。その中では、ダイマー内の相互 作用 A はβ'-1・CIO₄で 127 mV と僅かに小さく、DFT 計算 (Table 3-5, 2*J*/k_B = -1798.1 K) や抵抗率測定における低い活性化エネルギー (Table 3-4, 124 meV)、また、大きな室温磁 化率 ($\chi_MT \sim 0.08 \text{ emu·mol}^{-1}$)の結果と一致している。以上のように、対アニオン置換は b 軸方向の化学圧力として働き、 π 電子物性と相関していることが分かった。



Fig 3-9 (a) 伝導層中の分子配列における分子間相互作用 (b) 相互作用 C (c) 相互作用 D と(d) 相互作用 E

Transfer integral	β' -1·B F ₄	β'-1·ClO ₄	β'-1·PF ₆	β'-1·AsF ₆
	(270 K) [5]	(298 K)	(270 K)	(270 K)
A / meV	134	127	132	138
B / meV	4	3	1	2.1
C / meV	51	41	20	13
D / meV	0.7	0.7	0.6	0.6
E / meV	0.05	0.06	0.05	0.06

Table 3-6 β'-1·X (X = BF₄, ClO₄, PF₆, AsF₆)の伝導層(Fig. 3-9(a))における移動積分

Table 3-7 β'-1·X (X = BF₄, ClO₄, PF₆, AsF₆) における分子間の原子間近接距離

	β' -1·B F ₄	β'-1·ClO ₄	β'-1·PF ₆	β'-1·AsF ₆
	(270K) [5]	(298K)	(270K)	(270K)
① S…S / Å	3.575(1)	3.661(1)	3.947(3)	4.128(2)
② C(H)…O / Å	3.481(4)	3.464(5)	3.396(4)	3.375(7)
③ C(H)…S / Å	3.737(4)	3.793(4)	4.035(4)	4.194(6)
④ S…O / Å	3.032(2)	3.046(2)	3.057(2)	3.052(4)
5 O····O / Å	3.025(3)	3.034(5)	3.078(4)	3.094(7)

3-2-5. β'-1·BF₄の構造相転移メカニズムの考察

今回、合成したアニオン置換体 β '-1·X (X = ClO₄, PF₆, AsF₆) が前章の β '-1·BF₄ と同型構 造であるにも関わらず、物性の測定温度範囲において、相転移現象を示さなかったこと は驚くべき結果である。特に、対アニオンを BF₄から ClO₄ へ置換した時のわずかな体積 変化(Δ V = +0.91%) が、構造相転移挙動を制御していることは興味深い(Fig. 3-8)。この 物性挙動の違いとして、含有するアニオン自身の電気陰性度や熱運動の違い、またアニ オン置換による伝導層への化学圧力効果などの違いが考えられる。

室温付近での β' -1·BF₄の BF₄アニオンと β' -1·ClO₄の ClO₄アニオンにおいて、ドナー分 子との原子間距離 [Fig.3-3(a) (X = BF₄, 270 K), (b) (X = ClO₄, 298 K)] に大きな違いはない。 一方で、対アニオンと TTF 骨格の正電荷の間の静電的相互作用を考えると、ClO₄アニオ ンと TTF 骨格上の S 原子との O···S 相互作用より、BF₄アニオンの場合の F···S コンタク トの方が、電気陰性度の高いフッ素原子で接触しているので、より安定であると考えら れる。 β' -1·BF₄の転移に伴うこの F···S コンタクト距離の変化は、低温相の結晶学的に二 分子独立の BF₄アニオンで異なっており、片方は伸長するのに対して (Fig. 3-10(a))、も う片方は少し収縮する (Fig. 3-10(b))。つまり、片方の BF₄サイトでは安定化し、他方で は若干の不安定化がある。このような、静電的相互作用の利得が相転移に関係している と考えられるが、同様の S···F 相互作用が存在する β' -1·PF₆や β' -1·AsF₆ [Fig.3-3(c) (X = PF₆, 270 K), (d) (X = AsF₆, 270 K)]では、相転移が観測されていない。つまり、静電的相互作用 の利得だけでなく、アニオンの熱運動または、化学圧力効果の重要性が示唆される。



Fig. 3-10 β'-1·BF₄の転移に伴うこの F…S コンタクト距離の変化 [5] (a), (b) 150 K と(c) 270 K

また、室温付近での β '-1・BF₄の BF₄アニオンと 1・ClO₄の ClO₄アニオンにおいて、アニ オンの熱温度因子の大きさは類似しており[Fig.3-1(c) (X = BF₄, 270 K), (f) (X = ClO₄, 298 K)]、アニオン自身の熱運動やその周辺環境に大きな違いは見られない。そこで、このア ニオン置換が与える影響についてより詳細に議論するために、シンクロトロン放射光を 用いて 150 K における β '-1・ClO₄ と 240 K における β '-1・BF₄の結晶構造解析を行った。そ れぞれの結晶学的データを Table 3-8 に示す。

Fig. 3-11 に示すように、β'-1・BF₄(270K)とβ'-1・ClO₄(298K)において、アニオンは 同程度の熱温度因子を有していると思われる。相転移直上のβ'-1・BF₄(240K)の BF₄アニ オンの熱温度因子は、β'-1・BF₄(270K)より小さくなっており、熱運動が抑えられている。 一方で、物性測定範囲で転移が観測されなかったβ'-1・ClO₄においても、β'-1・ClO₄(150K) での ClO₄アニオンは、位置的な乱れを残しながら、その熱温度因子はβ'-1・ClO₄(298K) より小さくなっており、β'-1・BF₄の相転移挙動を誘起しているとは考えにくい。それ故に、 β'-1・BF₄とβ'-1・ClO₄での物性挙動の違いは、b 軸方向への異方的な化学圧力効果によって 変調されるドナー分子間相互作用が重要な役割を果たしていることを示唆している。



Fig.3-11 β'-1・ClO₄の水素結合ユニット構造とアニオン構造 (a) 150 K, (b) 298 K とβ'-1・BF₄ の水素結合ユニット構造とアニオン構造 (c) 240 K, (d) 270 K

	β '-1·BF 4	α-1·BF ₄	β'-1·ClO ₄
	(240 K)	(150 K) [5]	(150 K)
Formula	$C_{24}H_{15}O_8S_8B_1F_4\\$	$C_{24}H_{15}O_8S_8B_1F_4\\$	$C_{24}H_{15}ClO_{12}S_8$
Formula weight	774.66	774.66	787.31
Crystal System	triclinic	triclinic	triclinic
Space Group	<i>P</i> -1 (#2)	P-1 (#2)	<i>P</i> -1 (#2)
<i>a</i> / Å	7.2244(2)	7.1203(2)	7.1809(5)
b / Å	9.7489(3)	10.9390(4)	9.8084(9)
<i>c</i> / Å	10.8919(7)	18.0093(7)	10.851(1)
α / °	66.737(1)	78.1857(8)	66.647(3)
eta / °	85.514(2)	82.3285(10)	84.880(3)
$\gamma/$ °	79.059(2)	89.7204(11)	78.699(3)
$V/ \text{\AA}^3$	691.94(6)	1358.06(8)	688.0(1)
Z value	1	2	1
Temperature / K	240	150	150
$d_{\rm calc}$ / g·cm ⁻³	1.859	1.894	1.900
λ / Å	1.0000	1.0000	1.0000
# of observations	1726	3304	1700
# of variables	236	473	236
$R_1 (I > 2.0\sigma(I))$	0.0381	0.0330	0.0446
wR_2 (all data)	0.1115	0.0958	0.1323
GOF	1.097	1.048	1.104
0.01	1.021	1.010	1.101

Table 3-8 1·BF₄ (240 K (β'-), 150 K (α-) [5]) とβ'-1·ClO₄ (150 K) の結晶学的データ

そこで、*b*軸方向の化学圧力効果による**β'-1·BF**₄ と**β'-1·ClO**₄ の分子間相互作用の変化 に注目した。**4-2-4** で述べたように、アニオン置換による大きな変化として、相互作用 C の変化が~10 meV [**β'-1·BF**₄(270 K, 51.0 meV) → **β'-1·ClO**₄ (298 K, 41.0 meV)] と大きく、 それに対応して①S…S コンタクト距離の伸長 [**β'-1·BF**₄ (270 K): 3.575(1) Å → **β'-1·ClO**₄ (298 K): 3.661(1)] が見られる(Table 3-9)。つまり、**β'-1·BF**₄ のみに見られた相転移現象 では、相互作用 C や①S…S コンタクト距離の変化が重要な役割を担っていることが示唆 される。実際に、このアニオン置換によって、**β'-1·BF**₄ (270 K) の S…S 距離では、vdW 和 (S…S = 3.60 Å) 以下の 3.575(1) Å を有しているのに対して、**β'-1·ClO**₄ (270 K) ではそ れより長い 3.661(1) Å を有するという、大きな違いが見られる。つまり、**β'-1·BF**₄ (270 K) では**β'-1·ClO**₄ (298 K) に比べて、ドナー分子間の side-by-side 方向の①S…S コンタクトに よって有効な化学圧力が印加されていると考えられる。

Table 3-9 1·BF₄ (270 K, 240 K, 150 K) とβ'-1·ClO₄ (298 K, 150 K) の伝導層(Fig. 3-9(a)) に おける移動積分

	Transfer integral	β'-1·BF ₄ [5]	β' -1· BF ₄	α-1·BF ₄ [5]	β'-1·ClO ₄	β'-1·ClO ₄
		(270 K)	(240 K)	(150 K)	(298 K)	(150 K)
	A / meV	134	139	177, 166	127	144
	B / meV	4	6.8	43.8, 4.0	3	3.8
	C / meV	51.0	52.4	25.3	41.0	51.0
	D / meV	0.7	0.5	6.5, 0.13	0.7	0.6
	E / meV	0.05	0.08	0.08	0.06	0.11

Table 3-10 1·BF₄ とβ'-1·ClO₄の温度の違いによる原子間接触(Fig. 3-9(b), (c))距離の変化

	β' -1·B F ₄	β' -1· BF ₄	α-1·B F ₄	β'-1·ClO ₄	β'-1•ClO ₄
	(270 K) [5]	(240 K)	(150 K) [5]	(298 K)	(150 K)
(1) $S \cdots S / Å$	3.575(1)	3.554(1)	3.5542(9)	3.661(1)	3.571(1)
② C(H)…O / Å	3.481(4)	3.481(5)	3.257(3), 3.874(3)	3.464(5)	3.459(6)
③ C(H)…S / Å	3.737(4)	3.722(5)	3.359(2), 4.092(3)	3.793(4)	3.750(5)
④ S…O/Å	3.032(2)	3.030(3)	3.069(2), 3.097(2)	3.046(2)	3.011(4)
⑤ O…O / Å	3.025(3)	3.018(5)	3.048(2)	3.034(5)	3.004(5)

この S…S 方向からの異方的な化学圧力と磁気物性の相関を調べるために、Table3-10 に基づき、Fig. 3-12 に横軸 S…S 距離 (Fig. 3-9(b) ①)、縦軸に_{XM}T のプロットを行った。 β'-1·ClO₄の S····S 距離は、298 K で 3.661(1) Å と vdW 和 (S····S = 3.60 Å) より長いが、温 度低下と共に短くなり、150 K で vdW 和程度の 3.571(1) Å となる。この時、すでに ZMT は~0 emu K mol⁻¹でほぼ非磁性状態である。一方、β'-1·BF₄のS····S 距離は、270 K で 3.575(1) Åと vdW 和(S…S = 3.60 Å)よりすでに短く、温度低下と共にさらに収縮し、相転移直 前の 240 K で 3.554(1) Å となる。つまり、S…S 近接により、ドナー分子間により強い内 部圧力を有していると考えられる。一方で、β'-1·BF₄(240 K)のχ_MT 値は約 0.02 emu K mol⁻¹ であり、相転移温度まで有限である。そこで、β'-1·BF₄(~230 K)では、より強いスピン シングレット状態の形成によって、非磁性状態にドロップしてスピン電子系を安定化さ せるために、ユニット内水素結合が連動して約30°屈曲することでS…S近接による歪み を解消し、ドナー間の二量化を推進し(Fig. 3-13)、その結果、β'型からα型へのドナー配 列の劇的な変化を起こしたと考えられる。転移後に、体積収縮しているにもかかわらず [ΔV (β '-1·BF₄, 240 K - α -1·BF₄, 150 K) = ~ -12.9 Å³ / Z]、S···S は 3.5542(9) Å と転移前 (3.554(1) Å) とほぼ変わらないことからも、S…S 距離の近接が困難であったと考えられる。 つまり、1·BF4の水素結合自由度を利用した構造相転移では、①S…S コンタクト方向から の温度低下による圧力効果とダイマー内でのより強いスピンシングレット形成のエネル ギーの利得の両方が相乗的に働くことが重要であると現在のところ考えている。



Fig. 3-12 化学圧力とより強いスピンシングレット形成による安定化の相乗的効果による相転移の概念図



Fig. 3-13 β'-1・BF₄における (a), (c) S…S コンタクト方向からの内部圧力効果と (b), (d) 伝導層の関係: β'-1・BF₄ではβ'-1・ClO₄に比べて、化学圧力により、(a), (b) のように太矢 印方向の S…S 距離が縮小し、その結果、(c) で示す水素結合ユニットの屈曲と (d) に示 すより強い二量化 (2 重点線) による非磁性状態への安定化が協同的に働いて、分子配列 がβ'からα型へ相転換する。

3-3. 結論

第3章では、第2章で紹介した水素結合ユニット型伝導体 β '-1·BF₄と同型構造を有した 新規のアニオン置換体 β '-1·X (X = ClO₄, PF₆, AsF₆)を合成することに成功した。これらの 置換体はアニオン体積及び対称性の違いがあるにも関わらず、同型構造であり、アニオ ンの体積変化を利用した化学圧力効果を調査することができた。その結果、アニオン置 換による単位胞体積が増加するに従って、系統的に b 軸が大きく伸長しており、一方で a, c 軸の変化は小さく異方的な負の化学圧力が働いていることが分かった。伝導層 (ab 面)は b 軸を含むことから、アニオン体積の増加に従って室温抵抗率の上昇が見られた。 また、 β '-1·X (X = ClO₄, PF₆, AsF₆)の磁化率の温度依存性から、 β '-1·BF₄と同様の強いダ イマー性が示唆された。ダイマー内相互作用は格子変化の小さな a 軸方向に存在するた め、アニオン体積の変化に依存性は見られず、 β '-1·ClO₄ がその中では一番弱いダイマー 性を有していることが分かった。

さらに、抵抗率や磁化率の測定から 1・X (X = ClO₄, PF₆, AsF₆) では、同型構造の β '-1・BF₄ に見られた相転移現象が見られなかった。特に、 β '-1・BF₄ から β '-1・ClO₄ へのわずかなア ニオン体積変化 (ΔV = +0.91%) で劇的に π 電子物性が変化するのは非常に珍しく、格子 変調に敏感な相転移現象であることが示された。この違いについて化学圧力効果の大き な *b* 軸方向の相互作用変化に着目した結果、 β '-1・BF₄の相転移現象では、ダイマー内での より強いスピンシングレット形成のエネルギーの利得に加えて、S…S コンタクト方向か らの圧力効果が相乗的に働くことが重要であることが分かった。この相乗効果は、S…S 方向からの圧力によって水素結合ユニットが屈曲可能であること、つまり水素結合の幾 何学的な自由度を利用して、分子間の歪みを解消した結果、より密な構造形成としてダ イマー内距離が短くなった結果であると考えられる。今回、本研究で見出された、水素 結合自由度と π 電子系の新規相関を有する水素結合ユニット型伝導体において、アニオ ン置換体を合成し、その化学圧力効果を検証できたことは大変意義深い結果である。さ らに、この特異な系の相転移現象を調査していくことで、水素結合自由度を利用した外 場応答性の機能性物質の開発に期待が持たれる。 **1**•X (X = ClO₄, PF₆, AsF₆) の合成

新規結晶 β '-1·X (X = ClO₄, PF₆, AsF₆) は、 β '-1·BF₄の合成条件を参考に合成した[5]。H型 セルの片側に H₂Cat-EDO-TTF (3.0 mg, 8.7 mmol)、両側に支持電解質となる TBA·X (X = ClO₄, PF₆, AsF₆) をドナー分子に対して 2 当量ずつ (17.4 mmol) 加えて、アルゴン置換し た。脱水エタノール 1.5mL とクロロベンゼン 9.5mL を加えた後、白金電極を H 字管の両 側に挿入し、溶液に定電流 (~ 0.3 μ A) をかけることによって約 1 週間で黒色板状の結晶 を得た (~0.5 mg)。

X 線構造解析

高エネルギー加速器研究所 BL8A の放射光を用いて行った。X 線のエネルギーは 12.4 keV (X 線の波長 λ =1.0 Å)を使用し、振動写真法により回折点を IP (イメージングプレート、Rigaku) で収集した。測定および回折データの処理は Rigaku Rapid AUTO (Rigaku) を使用した。冷却 は He ガスの吹付けにより行い、PID 制御により温度制御を行った。結晶構造については結晶構造解析プログラムである Crystal Structure ver. 4.1 (Rigaku) を用いて直接法から求め、最小 二乗法により精密化した。 β '-1·X (X = ClO₄, PF₆, AsF₆) のすべてのエチレンジオキシ基の水 素は計算によって置いた。

電気伝導度測定

β'-1·X (X = ClO₄, PF₆, AsF₆)の単結晶を用いて、マルチチャンネル交流 4 端子伝導度計 HECS 994C型(扶桑製作所)による4端子測定を行った。金線(25 μ m ϕ)と試料の接合にはカ ーボンペースト (Dotite XC-12, JEOL)、を用いた。

磁化率測定

SQUID(超伝導量子干渉素子)磁気特性測定システム(MPMS) (Quantum Design)を用いて、 静磁化率測定を行った。それぞれ、β'-1·X (X = ClO₄, PF₆, AsF₆)の多結晶 ~ 3.0 mg を用いて、 磁場 1 T 下において 2 -300 K の温度範囲で測定した。データは、パスカル反磁性を差し引く ことで補正した。

理論計算

DFT は結晶構造解析で求めた座標を基に、Gaussian 03(B3LYP/6-31G(d))を用いて計算を行った。移動積分は、結晶構造解析で得られた座標を用いて拡張 Hückel 法で分子軌道を計算し、 分子軌道間の重なり積分に 10 eV を乗算して求めた[9]。

参考文献

[1] (a) D. Jérome, *Chem. Rev.*, 2004, **104**, 5565; (b) S. Kagoshima and R. Kondo, *Chem. Rev.*, 2004, **104**, 5593; (c) K. Murata, S. Kagoshima, S. Yasuzuka, H. Yoshino, and R. Kondo, *J. Phys. Soc. Japan*, 2006, **75**, 051015.

[2] (a) S. Aonuma, H. Sawa, and R. Kato, *Synth. Met.*, 1995, **70**, 1089; (b) R. Kato, *Bull. Chem. Soc. Jpn.*, 2000, **73**, 515.

[3] (a) U. Geiser, A. J. Schults, H. H. Wang, D. M. Watkins, D. L. Stupka, J. M. Williams, J. E. Schirber, D. L. Overmyer, D. Jung, J. J. Novoa, and M.-H. Whangbo, *Phys. C*, 1991, **174**, 475; (b)
M. Fourmigué, E. W. Reinheimer, K. R. Dunbar, P. Auban-Senzier, C. Pasquier, and C. Coulon, *Dalton Trans.*, 2008, 4652; (c) L. Zorina, S. Simonov, C. Mézière, E. Canadell, S. Suh, S. E. Brown, P. Foury-Leylekian, P. Fertey, J.-P. Pouget, and P. Batail, *J. Mater. Chem.*, 2009, **19**, 6980; (d) X. Shao, Y. Nakano, M. Sakata, H. Yamochi, Y. Yoshida, M. Maesato, M. Uruichi, K. Yakushi, T. Murata, A. Otsuka, G. Saito, S. Koshihara, and K. Tanaka, *Chem. Mater.*, 2008, **20**, 7551; (e) M. Dumm, D. Faltermeier, N. Drichko, M. Dressel, C. Mézière, and P. Batail, *Phys. Rev. B*, 2009, **79**, 195106.

[4] T. Mori, Bull. Chem. Soc. Jpn., 1998, 71, 2509.

[5] J. Yoshida, A. Ueda, A. Nakao, R. Kumai, H. Nakao, Y. Murakami, and H. Mori, *Chem. Commun.*, 2014, **50**, 15557.

[6] P. Guionneau, C. J. Kepert, G. Bravic, D. Chasseau, M. R. Truter, M. Kurmoo, and P. Day, *Synth. Met.*, 1997, **86**, 1973.

[7] T. Isono, H. Kamo, A. Ueda, K. Takahashi, A. Nakao, R. Kumai, H. Nakao, K. Kobayashi, Y. Murakami, and H. Mori, *Nat. Commun.*, 2013, **4**, 1344.

[8] B. Bleaney and K. D. Bowers, Proc. R. Soc. London, Ser. A 1952, 214, 451.

[9] T. Mori, A. Kobayashi, Y. Sasaki, H. Kobayashi, G. Saito, and H. Inokuchi, *Bull. Chem. Soc. Jpn.*, 1984, **57**, 627.

第4章 多様な水素結合電荷自由度によりπ電子系 TTF の酸化状態が制御された純有機 伝導体結晶の開発

4-1. 導入

水素結合性を持つドナー/アクセプター分子は、プロトン授受と酸化還元の間で多彩な 互変化異性を示すことから、分子の電子構造を制御する相互作用として興味が持たれる [1]。このような相互作用を固体物性に導入するため、これまでに、TTFπ 骨格に水素結 合性置換基が直接的に繋がったドナー分子が合成され、水素結合を利用した新規π電子 構造を持つ伝導体が開発されてきた[1c-d, 2]。例えば、TTF 骨格にプロトンドナー又はア クセプターとして働くイミダゾール環を置換したドナー分子(TTF-Im)は、Fig. 4-1 に示 すように多彩な電子状態をとりうる。実際に、TTF-Im やプロトン化した TTF-Im・H⁺とア クセプター分子が水素結合で繋がった電荷移動錯体が報告されており、水素結合部の荷 電様式がドナーーアクセプター間の電子移動と連動した特異な電子状態を作り出してい る[1c]。このような系では、アクセプターとの電荷移動相互作用が TTF 骨格の酸化状態を 決めている。



Fig. 4-1 TTF-Im におけるプロトン授受と酸化還元が連動したシステム[1c]

一方で、水素結合の荷電様式が TTF の酸化状態と連動する場合もある。第1章で説明 したように、2つの水酸基を持つ Cat-TTF 誘導体は、脱プロトン化と TTF 骨格が酸化さ れることで、特異な水素結合ユニット構造を持つ伝導体を構築してきた[3]。これらの系 では、ユニット内のアニオン性水素結合[O···H···O]⁻ が TTF 骨格の酸化状態の電荷をすべ てまたは一部補償している。例えば、κ-H₃(Cat-EDT-TTF)₂ ではアニオンを含まない中性の 水素結合ユニットのみから構成される純有機伝導体が、第2章の β '-H₃(Cat-EDO-TTF)₂X (X = BF₄, ClO₄, PF₆, AsF₆) では、カチオン性水素結合ユニットとの電荷移動錯体が得られて いる[3d]。このように、アニオン性水素結合[O···H···O]⁻と連動して、 π 電子系酸化型 TTF の電子状態が決められている。

第4章では、Cat-TTF 誘導体の水素結合の多様化や多次元化により、π電子構造と新規 の相関を有する伝導体の開発を目的として、カテコールを TTF 両端に縮環した新規ドナ ー分子(H₂Cat)₂-TTF (Fig. 4-2(a))を合成した。この水素結合部を両端に持つ新規ドナー分 子を基盤とした水素結合ユニットでは、EDT や EDO 基を持つドナー分子との酸化還元性 の違いによるユニット内の電子構造の変調効果だけなく、ユニット間にも水素結合を持 つことが期待される (Fig. 4-2(b))。これらの水素結合では、カテコール部位の脱プロトン 化と酸化還元が連動した多彩な電子状態に由来した水素結合を形成することが考えられ る(Fig. 4-2(a))。実際に、この系では、ユニット内の脱プロトン型のアニオン性水素結合 [O···H···O]⁻だけなく、ユニット間に中性の水素結合を形成し、水素結合電荷の自由度に 由来した特異な電子構造をもつ水素結合ユニットを形成していた。その結果、すべての ドナーTTF 分子は~+0.25 の価数となっており、水素結合の電荷自由度を利用した酸化状 態の制御が行われている。



Fig. 4-2 (a) カテコールが TTF 両端に縮環したドナー分子(H₂Cat)₂-TTF と (b) (H₂Cat)₂-TTF を基盤とした水素結合ユニット

4-2. 結果と考察

4-2-1 新規ドナー分子(H₂Cat)₂-TTF の合成とその特性評価

新規ドナー分子の(H₂Cat)₂-TTF を、以下に示す Scheme 4-1 に従い合成した。原料のカ テコール骨格が TBDMS (*tert*-Butyldimethylsilyloxy) 保護されたチオン体(3a) [4] は文献に 従って合成した。まず、(a) チオン体 3a を酢酸水銀により、ケトン体 3b に変換し、(b) 亜 リン酸トリエチルを用いたホモカップリングによって、[(TBDMS)₂Cat]₂-TTF を得た。続 いて、TBA・F を用いて脱保護を行い、新規ドナー分子(H₂Cat)₂-TTF の合成をした。



Scheme 4-1 (H₂Cat)₂-TTF の合成スキーム

まず、合成したドナー分子の CV(cyclic voltammetry) 測定を行い、酸化還元特性を調べた。CV 測定の結果を Fig. 4-3、酸化還元電位の値と他のドナー分子との比較を Table 4-1 に示す。今回、ドナー分子が大気中不安定であることから、CV 測定において正確な酸化 還元を決定することはできなかった。EDT 体とその TBDMS-保護体の酸化電位の比較から、TBDMS 保護基と水酸基が TTF 骨格に与える電子的効果はほぼ同一であると考えられる。そこで、前駆体[(TBDMS)₂Cat]₂-TTF の CV 測定を行うことで、両端にカテコール を縮環させたドナー分子の酸化還元能を評価した。

CV 測定の結果、[(TBDMS)₂Cat]₂-TTF は 2 段階の可逆な酸化還元波を示し、それぞれの 半波電位は $E^{1}_{1/2}$ = +0.47 V、 $E^{2}_{1/2}$ = +0.83 V であった。片側カテコール縮環体ドナーと 比較すると、それぞれ、EDT や EDO 体より高い第一酸化電位を示した。一方で、ベンゼ ンが TTF 両端に縮関している DBTTF と比較すると、より低い酸化電位であり、 [(TBDMS)₂Cat]₂-TTF の 4 つのシラノール基の電子供与性置換基効果によってドナー性の 向上が見られた。



Fig.4-3 [(TBDMS)₂Cat]₂-TTFのCV測定

Table 4-1 [(TBDMS)₂Cat]₂-TTFの酸化還元測定と他のドナー分子との比較(vs. SCE) [(TBDMS)₂Cat]₂-TTF, DBTTF はジクロロメタン、(TBDMS)₂(Cat-EDT-TTF), H₂(Cat-EDT-TTF), H₂(Cat-EDO-TTF) はアセトニトリルを溶媒として、Bu₄N·ClO₄ (0.1 M) を電解質として用いている[3d, 4, 5]。スキャンスピードは、0.05 V/s である。

Donor	$E^1_{1/2}$ / V	$E^{2}_{1/2}$ / V	$\Delta E / V$
[(TBDMS) ₂ Cat] ₂ -TTF	+0.47	+0.83	0.36
(TBDMS) ₂ Cat-EDT-TTF	+0.40	+0.65	0.25
H ₂ Cat-EDT-TTF [4]	+0.40	+0.65	0.25
H ₂ Cat-EDO-TTF [3d]	+0.35	+0.62	0.27
DBTTF [5]	+0.64	+1.06	0.42

次に、Fig. 4-4 にドナー分子の結晶構造(H₂Cat)₂-TTF·2H₂O を示す。結晶は、ドナー分子 を溶かしたメタノール溶媒に貧溶媒のジクロロメタンを拡散させることで得た。結晶の 空間群は $P2_1$ であり、結晶中には、ドナー1 分子と結晶学的に非等価な 2 つの結晶水を含 んでいる。ドナー分子の C-O 結合距離は、1.369 ~ 1.387 Å であり、脱プロトン型水素結 合[O···H···O]⁻ を形成している場合の C-O 距離と比較すると (Table 4-2 & Fig. 4-5, ③C-O, 1.310(2) ~ 1.340(3) Å)、より長く、4 つの水酸基は脱プロトン化していない。TTF 骨格の 電荷状態に依存が見られる C=C 結合距離は 1.356(5) Å であり、中性の Cat-TTF 誘導体 (Cat-EDT-TTF = 1.345(7) Å, Cat-EDO-TTF = 1.347(8) Å) よりやや長い。しかしながら、
TTF 骨格の酸化数が+0.5 価の H₃(Cat-EDT-TTF)₂ (1.368(4) Å) や+1 価の
[H₃(Cat-EDO-TTF)₂]BF₄ (1.386(4) Å) と比べると短く、中性であることと一致している。
また、多くのTTF 中性ドナー分子に見られるのと同様に、(H₂Cat)₂-TTF は約 12° で硫黄
原子を支点として屈曲している。



Fig. 4-4 (H₂Cat)₂-TTF•2H₂Oの結晶構造:ドナー骨格(a)上部, (b)サイド

 Table 4-2 Cat-TTF 誘導体とそれらの水素結合ユニットにおける C-O と C=C 距離(下記の

 化学構造式参照)

Cat-TTF 誘導体	① C-O/Å	② C-O/Å	③ C-O / Å	④ C=C / Å	
H ₂ Cat-EDT-TTF (298 K)	1.362(7)	1.380(6)	—	1.345(7)	
H ₂ Cat-EDO-TTF (298 K) [3d]	1.377(5)	1.377(5)	—	1.347(8)	
H ₃ (Cat-EDT-TTF) ₂ (298 K)[3a]	1.360(4)	—	1.340(3)	1.368(4)	
[H ₃ (Cat-EDO-TTF) ₂]BF ₄ (270 K) [3d]	1.353(4)	_	1.310(2)	1.386(3)	



Fig. 4-5 Cat-TTF 誘導体とそれらの水素結合ユニットの化学構造式 (X = S : Cat-EDT-TTF, X = O : Cat-EDO-TTF)

両端のカテコール部位は、水分子と(2.695~2.911 Å, Fig. 4-6 の紫色の点線)多様な水 素結合を形成している。これは、片側カテコール縮環体の EDT 体や EDO 体の中性ドナ ーに水素結合が見られないことと対照的であり、両端にカテコールを導入したことで、 ドナー分子の水素結合相互作用がより強く結晶のパッキングに反映された結果であると 考えられる[3d, 4]。隣接のドナー分子間において、カテコール部位の酸素原子と TTF 骨 格の硫黄原子の間に vdW 和より短い原子間接触が見られた(Fig. 4-6a の緑の点線)。一方 で、TTF 骨格間の S…S 距離には vdW 和(3.60 Å)より短い原子間接触は見られず、これ は、水素結合やπ-π相互作用が結晶パッキングにおいて優先的に働いていることを示唆し ている(Fig. 4-6(a)の黄色の点線)。ドナー分子は、ring over atom 型の重なり方(Fig. 4-6(b)) で、約 3.49 Å の間隔で均一に積層している(Fig. 4-6(c), 4-6(d))。



Fig. 4-6 (H₂Cat)₂-TTF·2H₂Oの結晶構造:(a) 分子配列 *ac* 面,(b) 分子間の重なり,(c) 分子の面間距離,(d) 分子配列

4-2-2 (H₂Cat)₂-TTF を基盤とした伝導体θ-2の合成と結晶構造

次に、新規に合成した(H₂Cat)₂-TTF を基盤とした伝導体の合成を Scheme 4-2 に従って 行った。伝導体は、アセトン溶媒中に(H₂Cat)₂-TTF と支持電解質として n-Bu₄N·PF₆、塩 基として 2, 2'-ビビリジンを溶解させ、約 1 週間、 0.3μ A の定電流により電気化学的酸化 を行うことによって黒色の結晶(θ -2)を得た。



Scheme 4-2 (H₂Cat)₂-TTF を基盤とした伝導体**0–2**の合成

θ-2は、シンクロトロン放射光を用いて、200 K で X 線構造解析を行った。Table 4-2 に結晶学的データを記載した。**θ-2**は、空間群 $P2_1/n$ で、Fig. 4-7(a) に示すように2 種類 の結晶学的に独立なドナー分子 I と II から構成されている。I, II 間には vdW 和より短い 分子間 S···S コンタクト(3.5888(9) Å) がある。Fig. 4-7(b) に分子配列を示す。I と II はそ れぞれ分離して b 軸方向に均一に積層し、それぞれのカラムは 2 周期ごとに入れ替わっ ている。隣接カラム間のドナー分子は 2 面角~150°を成しており、いわゆる"0型様[7]" の分子配列を形成している。I と II からなるカラムの分子間距離は、それぞれ~3.44 Å、 ~3.43 Å であり、それぞれ、Fig. 4-7(c), (d) に示したような、ring-over-bond 型の重なり方 をしている。興味深いことに、**θ-2** は結晶中にアニオンを含まない構造をしている。この ことから、脱プロトン化により生じるアニオン性水素結合によって、酸化されたドナー 分子の電荷補償が行われていると考えられる。

そこで初めに、結晶中のドナー分子間の水素結合様式について注目する。Fig. 4-7(a) に 示すように、結晶中にはそれぞれ、①I 分子同士、②II 分子同士、③I と II の間から形成 される3種類の水素結合様式が存在する。①では、EDT 体や EDO 体に見られるような、 カテコール部位で脱プロトン型の水素結合によって繋がれたユニット構造を形成してい る。②では、1 つの酸素原子に対して多くの水素結合の形成が見られ、水素結合中の水素 の位置に乱れが示唆された。本章では、①を形成している I 分子同士を水素結合ユニット と呼ぶのに対して、②を形成する II 分子同士をディスオーダーユニットと呼ぶこととす る。そして、③では、①と②を繋ぐ役割を果たしており、片側カテコール縮環体では見 られなかった3次元的な水素結合ネットワーク構造を実現している。それぞれの水素結 合様式の詳細について以下に述べる。



Fig. 4-7 (H₂Cat)₂-TTF を基盤とした伝導体θ-2 の結晶構造 (a) ac 面、(b) θ型分子配列、
(c) I と(d) II のドナー分子の重なり
Fig. 4-8 に示すように、①では、2 種類の水素結合が存在し、その O…O 距離は 2.533(2), 2.600(2) Å である。これは、 κ -H₃(Cat-EDT-TTF)₂の水素結合ユニット内およびユニット間 の水素結合 O…O 距離(2.486(5), 2.640(2) Å)[3a] と近い値である。さらに、 θ -2 につい て、X 線構造解析の差フーリエによると 2 つの酸素の中心に差電子密度が存在している ことから、酸素原子の中央に水素原子が存在しており、ユニット内は脱プロトン型水素 結合[O…H…O]⁻ であることが示唆される(Fig. 4-8)。加えて、水素結合部のカテコール の C-O 距離は、一方の 1.372(3) Å に比べて水素結合を形成している方では 1.341(3) Å と、 κ -H₃(Cat-EDT-TTF)₂における 1.340(3) Å と同様に短いことから、脱プロトン化しているこ とと一致している(Fig. 4-8(c))。



Fig. 4-8 水素結合ユニットにおける (a) 水素結合距離、(b) 水素結合部の差フーリエ マップ、(c) C-O 結合距離

②では3種類の水素結合が存在しており、O…O距離は2.724(3), 2.788(3), 2.983(3) Åで あった(Fig. 4-9(a))。それぞれの C-O距離は1.317(3), 1.332(3) Åと水酸基の C-O距離 (1.372(3) Å)にしては短いため、脱プロトン化していることが示唆される(Fig. 4-9(b))。 さらに、Fig. 4-9(c)のように、ベンゼン環に結合交代が確認されることから、この脱プロ トン化構造として Scheme 4-3 のような反応によって、一部のカテコール構造が *o*-benzoquinone 構造へと変化したことが考えられる。この2 種(*o*-dihydroxybenzene と *o*-benzoquinone)のディスオーダーの割合が C-O距離と比例していると仮定して、DFT 計 算による*o*-dihydroxybenzene と*o*-benzoquinoneの最適化構造のC-OまたはC=O距離から、 ディスオーダーの割合を見積もると、約 30%の割合で *o*-benzoquinone 体を含むことが示 唆された (Fig. 4-10)。しかしながら、水素結合の脱プロトン化と TTF 酸化によって多彩 な電子構造をとれることから、Fig. 4-11 に示すような、*o*-dihydroxybenzene から *o*-benzoquinone 構造を生成する過程における中間体のディスオーダー種も考えられるこ とは留意すべきである。



Fig.4-9 ディスオーダーユニットにおける (a) 水素結合距離、(b) C-O 結合距離、(c) カ テコール部位のベンゼン炭素間の結合距離



Scheme 4-3 (H₂Cat)₂-TTF の脱プロトン化と酸化による o-ベンゾキノン構造の生成



Fig 4-10 DFT 計算による最適化構造の C-O, C=O 結合距離から見積もった *o*-dihydroxybenzene 構造と *o*-benzoquinone 構造のディスオーダーの割合



Fig. 4-11 脱プロトン化と TTF 酸化による多彩な電子構造

	θ-2	(H ₂ Cat) ₂ -TTF·2H ₂ O
Formula	$C_{28}H_{16}O_8S_8$	$C_{14}H_{12}O_6S_4$
Formula weight	736.91	404.50
Crystal System	monoclinic	monoclinic
Space Group	<i>P</i> 2 ₁ /n (#14)	<i>P</i> 2 ₁ (#4)
<i>a</i> / Å	23.7246(4)	12.512(6)
b / Å	3.7461(4)	3.9100(18)
<i>c</i> / Å	29.3664(7)	16.412(8)
lpha / °	90.000	90.000
eta / °	92.6661(7)	103.929(7)
γ/ °	90.000	90.000
$V/\text{\AA}^3$	2607.1(3)	722.24(6)
Z value	4	2
Temperature / K	200	270
$d_{\rm calc}$ / g·cm ⁻³	1.877	1.570
λ / Å	1.0000	0.71073
# of observations	4601	3432
# of variables	450	249
$R_1 (I > 2.0\sigma(I))$	0.0362	0.0413
wR_2 (all data)	0.1010	0.0952
GOF	0.927	1.065
Flack Parameter	-	-0.02(11)

Table 4-3 (H₂Cat)₂-TTF を基盤とした伝導体**0-2** とドナー分子の結晶学的データ

有機伝導体0-2におけるドナー分子の電荷状態を調べるために、X線構造解析による TTF 骨格の結合長を用いて計算を行った。その結果、Table 4-4 に示したように、I および II におけるドナー分子の電荷 Q'は約+0.28(4) および+0.29(4) 価と、ほぼ同じ酸化状態で あることが見積もられた。結晶中では、脱プロトン型水素結合[O···H···O]⁻の負電荷に対 して4つのドナー分子(I×2, II×2)が電荷補償している。つまり、電荷見積もりの結果 と合わせて考えると、それぞれのドナー分子 I, II は、約+0.25 価であることが示唆された。

	Ι	Π	(H ₂ Cat) ₂ -TTF·2H ₂ O
a / Å	1.361(3)	1.357(4)	1.356(5)
b / Å	1.743(2)	1.748(2)	1.754(3)
	1.743(2)	1.741(2)	1.759(4)
b' / Å	1.741(2)	1.743(2)	1.763(4)
	1.742(2)	1.743(2)	1.757(3)
c / Å	1.754(2)	1.747(2)	1.767(4)
	1.736(2)	1.739(2)	1.759(3)
c' / Å	1.752(2)	1.744(2)	1.759(3)
	1.742(2)	1.756(2)	1.754(4)
d / Å	1.397(3)	1.407(3)	1.391(5)
d' / Å	1.396(3)	1.394(3)	1.393(5)
δ^a / Å	0.730(5)	0.724(5)	0.773(9)
δ'^b / Å	0.732(5)	0.742(5)	0.768(9)
Q^c	0.893(2)	0.879(2)	0.60(4)
Q'^d	0.29(4)	0.28(4)	0

Table 4-4 TTF 骨格の結合長からの電荷見積もり[3a, 6]



Fig. 4-12 (H₂Cat)₂-TTF における化学結合

さらに、有機伝導体 θ -2におけるドナー分子の電荷状態を確認するために、ラマン分光 スペクトルの測定を行った(Fig. 4-13)。中性のドナー分子は不安定であるため、 (H₂Cat)₂-TTF と 4, 4'-ビビリジン(bpy)から構成される水素結合性の共結晶を中性ドナー 分子の参照とした。また、1 価の(H₂Cat)₂-TTF の参照として、結晶中に 2 分子の(H₂Cat)₂-TTF (~+1)と1分子の(H₂Cat)₂-TTF (~+0)を含む、3:2塩の電荷移動塩を用いた。それぞれ、 中性と+1の(H₂Cat)₂-TTF のラマンスペクトルは、Gaussian03を用いて(U)B3LYP /6-31G(d) レベルで計算した。このときのスケーリングファクターは 0.96 とした。

TTF 骨格の C=C 伸縮振動は、酸化状態と相関があることが知られている。DFT 計算の 結果から、それぞれ参照として用いたドナー分子の C=C 伸縮振動は、中性が 1536 cm⁻¹,+1 価が 1414 cm⁻¹に帰属される。2 のドナー分子の C=C 伸縮振動は 1505 cm⁻¹に存在してお り、中性と+1 価の中心 1475 cm⁻¹ から高波数側である。また、C=C 伸縮振動に対応するピ ークは一つである。これらの結果から、0-2 結晶中の I と II 分子はほぼ同一の酸化状態で あり、その酸化状態は TTF 結合長から見積もられる~+0.25 価 [= (1536-1505) / (1536-1414)] を強く示唆している。



Fig. 4-13 ラマンスペクトル (a)黒線: 0-2 結晶、青線: [(H₂Cat)₂-TTF)]₃(CF₃SO₃)₂·2acetone、
赤線: [(H₂Cat)₂-TTF] (4, 4'-bpy)、(b) DFT (B3LYP/6-31G(d)) による中性(赤線) と+1 価
(青線)の最適化構造から求められたスペクトル

4-2-3 θ-2のπ電子物性

θ-2の結晶構造とπ電子物性の関係について調べるため、分子配列中の各移動積分を計算した (Fig. 4-14, Table 4-5) [8]。その結果、積層方向に強い相互作用 (A = 67.3 meV, B = 61.5 meV)を持つことが分かった。一方で、カラム間にも有効な相互作用 (C = 31.4 meV, D = 38.2 meV, E = 14.9 meV, F = 12.1 meV) を有しており、中でも、相互作用 D は vdW 半径より短い S…S コンタクト (Fig. 4-7a, 3.5888(9) Å)を反映してカラム間で一番大きな相互作用を有していた。このように、θ-2は、カラム内だけでなくカラム間に有効な相互作用を有しており、2 次元的な伝導層を形成していることが分かった。



Fig. 4-14 0-2 (200 K) の分子配列における分子間相互作用

Table 4-3 \mathbf{D} -2 (200 K) の公会層 (Fig. 4-14) にわける 後期性	Table 4-5	θ–2 (200 K)	の伝導層	(Fig. 4-14))における移動積	分
---	-----------	--------------------	------	-------------	----------	---

	А	В	С	D	E	F
Transfer integral / meV	67.3	61.5	31.4	38.2	14.9	12.1

単結晶による電気抵抗率測定の結果から、約 300 meV の活性化エネルギーの半導体的 挙動を示し、室温抵抗率 ~10 Ω·cm を示す良伝導体であった (Fig. 4-15a)。この結果から、 水素結合部の脱プロトン化に対して、電荷補償として TTF 骨格の酸化が起こり、キャリ アドープされていることがわかる。また、磁化率測定の結果、低次元磁性に特有な低温 部での極大を示した (Fig. 4-15b)。2 次元反強磁性ハイゼンベルグモデル[9] を用いて 2J/k_B ~ -40 K として最適化を行った。この時の磁化率の大きさから、ドナー分子が~+0.28 の 酸化状態であることが示唆され、これは結合長(+0.28(4), +0.29(4))及びラマン分光(~ +0.25) から示唆されたドナー分子の価数の解析結果とよく一致している。



Fig. 4-15 θ-2 の (a) 抵抗率の温度依存性と、(b) 磁化率の温度依存性(点線は2次元ハ イゼンベルグモデルによるフィッティング[9])

以上の結果から、0-2の結晶中には水素結合の荷電様式の異なる2種類のユニット構造 が存在しており、I分子同士のユニット中のアニオン性水素結合(-1価)とII分子同士 のユニット中のディスオーダー構造が見られる水素結合(0価)に対して、IとIIのドナ ー分子が約+0.25 価とほとんど差がなく酸化されていることが強く示唆された。つまり、 水素結合部の脱プロトン量に対応して、TTF が酸化されており、その結果、アニオンを 含まない純有機伝導体を構成していることが示された。

4-3. 結論

多彩な水素結合サイトと酸化還元能が相関する新規電子ドナー分子(H₂Cat)₂-TTF を基 盤として、多様な水素結合の電荷自由度によりπ電子系 TTF の酸化状態が制御された純 有機伝導体結晶0-2 を合成することに成功した。この伝導体0-2 の単結晶は、塩基の存在 下、電気分解することで、酸化と同時に脱プロトン化することによって得た。伝導度測 定から、結晶は室温伝導度~10 Ω·cm を示す良伝導体であった。X 線構造解析を行ったと ころ、伝導体0-2 は 2 分子の結晶学的に独立なドナー分子のみから構成されており、ドナ ー分子同士が水素結合で繋がれていることが分かった。結晶における水素結合様式は、 脱プロトン型[O···H···O]⁻、非脱プロトン型、およびディスオーダー型の 3 種類存在して おり、脱プロトンによる負電荷を補償して TTF 骨格が酸化されていた。その酸化状態は、 TTF 骨格の結合長の解析から~+0.25 価と見積もられ、磁化率測定とラマン測定かともよ く一致している。このような珍しい酸化状態は、脱プロトン化によって発生する水素結 合部の負電荷と TTF 骨格の酸化の連動性だけでなく、多様な水素結合を分子間に形成す ることで、部分的な脱プロトン化構造の安定化を達成したことが重要な役割を果たして いる。

この研究では、水素結合サイトの脱プロトン化を利用して、TTF の酸化状態の制御を 実現することが可能であることを示した。これは、従来型の TTF 基盤としたラジカル塩 とは異なり、水素結合の電荷自由度を活用した全く別のコンセプトを与えた大変意義深 い結果であり、有機伝導体の研究に新たな指針を示した。 実験

新規ドナー(H₂Cat)₂-TTFの合成

アルゴン置換した 300 mL ナスフラスコに合成したチオン体 **3a**, 4.73 g (10.6mmol) [4]を 入れ、クロロホルムを 120 mL に溶解させた。酢酸 20.0 mL と酢酸水銀 6.73 g (21.1 mmol) を加え、室温で 8 時間撹拌した。反応溶液をセライトろ過し、クロロホルムで洗浄した。 ろ液を炭酸水素ナトリウム飽和溶液で中和し、クロロホルムで分液した後、有機層に硫 酸マグネシウムを加え乾燥させたジクロロメタンを用いてカラムクロマトグラフィーを 行い、ロータリーエバポレーターで溶媒を除去し、ケトン体である白色固体 **3b** を得た。 収量: 3.61 g (収率: 79.4 %);¹H NMR (300 MHz, CDCl₃) δ: 0.21 (s, 12H), 0.99 (s, 18H), 7.05 (s, 2H)



Scheme 4-4 ケトン体 **3b** の合成

アルゴン置換した 30 mL ニロフラスコにケトン体 3b, 858 mg (2.0 mmol) を入れ、シリ ンジを用いて、脱水した亜りん酸トリエチル P(OEt)₃7.5 ml を加えた。115°C にて、5 時 間攪拌後、真空ポンプを用いて溶媒を除去した。メタノールを加え、吸引濾過し、黄色 の[(TBDMS)₂Cat]₂-TTF 固体を得た。収量:532 mg (収率:32.2%);¹H NMR (300 MHz, CDCl₃) δ: 0.18 (s, 24H), 0.97 (s, 36H), 6.72 (s, 4H)



Scheme 4-5 [(TBDMS)₂Cat]₂-TTF の合成

アルゴン置換した 50 mL ニロフラスコに[(TBDMS)₂Cat]₂-TTF 68.8 mg (0.083 mmol) を 入れ、THF 35 mL に溶かした。10 分撹拌した後、酢酸 10 µL と Bu₄N·F (1M in THF) 0.5 mL を加え、3 時間撹拌した。黄色の沈殿を吸引濾過して、ヘキサンで洗浄した。この固体を、 最小量のメタノール (~ 10 mL) に溶かし、ジクロロメタン 200 mL を加えた後、メタノ ールとジクロロメタン(3:40) の混合溶媒でカラムクロマトグラフィーをした。ロータリ ーエバポレーターで溶媒を除去し、黄土色の固体(H₂Cat)₂-TTF を得た。収量:24.0 mg (収 率:78.5%);¹H NMR (300 MHz, d₆-acetone) δ : 6.90 (s, 4H); IR (KBr): 3600-3000 (結晶水や カテコール部位の水酸基に由来する), 1700(w), 1594(s), 1489(s), 1423(s), 1345(m) 1317(m), 1294(s), 1215(m), 1156(s), 1115(m), 1110(m), 960(w), 860(s), 855(s), 800(s), 774(s) 696(s), 634(s), 580(w) cm⁻¹



Scheme 4-6 (H₂Cat)₂-TTF の合成

得られた新規ドナー(H₂Cat)₂-TTFは、大気不安定なため、合成してすぐに電解合成に用いた。

θ-2 の合成

新規伝導体 θ -2 は、 κ -H₃(Cat-EDT-TTF)₂の合成条件を参考に合成した[4]。H型セルの片 側に(H₂Cat)₂-TTF (3.0 mg, 8.1 mmol) と塩基として 2, 2'-bipyridie 1.9 mL (12.2 mmol)、また、 両側に支持電解質となる *n*-Bu₄N·PF₆ 6.3 mg (17.4 mmol) をドナー分子に対して 2 当量ず つ加えて、アルゴン置換した。脱水アセトン 11.5 mL を加えた後、白金電極を H 字管の 両側に挿入し、溶液に定電流 (~ 0.3 μ A) をかけることによって約 1 週間で黒色板状の結 晶を得た (~0.2 mg)。

X 線構造解析

高エネルギー加速器研究所 BL8A の放射光を用いて行った。X 線のエネルギーは 12.4 keV (X 線の波長λ = 1.0 Å)を使用し、振動写真法により回折点を IP(イメージングプレート、 Rigaku)で収集した。測定および回折データの処理は Rigaku Rapid AUTO(Rigaku)を使用し た。冷却は He ガスの吹付けにより行い、PID 制御により温度制御を行った。結晶構造につい ては結晶構造解析プログラムである Crystal Structure ver. 4.1 (Rigaku)を用いて直接法から求 め、最小二乗法により精密化した。

電気抵抗率測定

θ-2の単結晶を用いて、マルチチャンネル交流4端子伝導度計 HECS 994C型(扶桑製作 所)による疑似4端子測定を行った。金線(25 μm φ)と試料の接合にはカーボンペースト(Dotite XC-12, JEOL)を用いた。

磁化率測定

SQUID(超伝導量子干渉素子)磁気特性測定システム(MPMS) (Quantum Design)を用いて、 静磁化率測定を行った。それぞれ、0-2の多結晶 ~ 1.4 mgを用いて、磁場1T下において2-300 Kの温度範囲で測定した。静磁化率は、パスカル反磁性で補正した。

理論計算

DFT は結晶構造解析で求めた座標を基に、Gaussian 03(B3LYP/6-31G(d))を用いて計算を行った。移動積分は、結晶構造解析で得られた座標を用いて拡張 Hückel 法で分子軌道を計算し、 分子軌道間の重なり積分に 10 eV を乗算して求めた[7]。

参考文献

- [1] (a) T. Mitani, G. Saito, and H. Urayama, *Phys. Rev. Lett.*, 1988, **60**, 2299; (b) T. Akutagawa, T. Hasegawa, T. Nakamura, T. Inabe, and G. Saito, *Chem. A Eur. J.*, 2002, **8**, 4402; (c) T. Murata, Y. Morita, Y. Yakiyama, K. Fukui, H. Yamochi, G. Saito, and K. Nakasuji, *J. Am. Chem. Soc.*, 2007, **129**, 10837; (d) Y. Morita, T. Murata, and K. Nakasuji, *Bull. Chem. Soc. Jpn.*, 2013, **86**, 183.
- [2] M. Fourmigué and P. Batail, Chem. Rev., 2004, 104, 5379.
- [3] (a) T. Isono, H. Kamo, A. Ueda, K. Takahashi, A. Nakao, R. Kumai, H. Nakao, K. Kobayashi, Y. Murakami and H. Mori, *Nat. Commun.* 2013, 4, 1344; (b) A. Ueda, S. Yamada, T. Isono, H. Kamo, R. Kumai, H. Nakao, Y. Murakami, K. Yamamoto, Y. Nishio and H. Mori, *J. Am. Chem. Soc.* 2014, 136, 12184; (c) T. Isono, H. Kamo, A. Ueda, K. Takahashi, M. Kimata, H. Tajima, S. Tsuchiya, T. Terashima, S. Uji and H. Mori, *Phys. Rev. Lett.* 2014, 112, 177201; (d) J. Yoshida, A. Ueda, A. Nakao, R. Kumai, H. Nakao, Y. Murakami, and H. Mori, *Chem. Commun.*, 2014, 50, 15557; (e) A. Ueda, A. Hatakeyama, M. Enomoto, R. Kumai, Y. Murakami, and H. Mori, *Chem. A Eur. J.*, 2015, 21, 15020.
- [4] H. Kamo, A. Ueda, T. Isono, K. Takahashi and H. Mori, Tetrahedron Lett. 2012, 53, 4385.
- [5] T. Senga, K. Kamoshida, L. A. Kushch, G. Saito, T. Inayoshi, and I. Ono, *Mol. Cryst. Liq. Cryst.*, 1997, **296**, 97.
- [6] P. Guionneau, C. J. Kepert, G. Bravic, D. Chasseau, M. R. Truter, M. Kurmoo, and P. Day, Synth. Met., 1997, 86, 1973.
- [7] T. Mori, H. Mori, and S. Tanaka, Bull. Chem. Soc. Jpn., 1999, 72, 179.
- [8] T. Mori, A. Kobayashi, Y. Sasaki, H. Kobayashi, G. Saito, and H. Inokuchi, Bull. Chem. Soc. Jpn., 1984, 57, 627.
- [9] M. E. Lines, J. Phys. Chem. Solids, 1970, 31, 101.

第5章 総括

本研究では、水素結合の自由度と π 電子物性の相関に基づく新規 π 電子物性、動的 現象の開拓を目指し、以下の2種類の Cat-TTF ドナー分子を用いた新規水素結合ユニッ ト型有機伝導体の合成を行い、その結晶構造とπ電子物性を詳細に調査した。

- π電子系分子の電子構造を変調させ、水素結合--π電子物性の相関への影響を調べ、 制御するために、エチレンジオキシ(EDO) 基を有するドナー分子 H₂Cat-EDO-TTF を 用いたところ、両者の相関の基本単位であるカチオン性水素結合ユニットに加え、ア ニオンを含む4種類の同型構造の水素結合ユニット型伝導体を得ることに成功した。
- ② π電子系分子間の水素結合様式を電子構造と共に変調させ、水素結合一π電子物性の 相関への効果を調べ、制御するために、カテコールが TTF 両端に縮環されたドナー分 子(H₂Cat)₂-TTF を用いたところ、水素結合ユニットのみから構成される伝導体を得る ことに成功した。

これらの相関系水素結合ユニットを基盤とした伝導体について、ユニットの電子構造 や分子配列、電気伝導性や磁性を調べることで、水素結合の自由度とπ電子物性の相関 が構造と物性に与える効果を明らかし、その相関を基盤とした π 電子物性や動的現象を 見出した。以下に、本研究で明らかになった事項を各章ごとにまとめた。 第2章では、上記①で示したように、 π 電子系分子の電子構造を変調するために H₂Cat-EDO-TTFを用いて新規の水素結合ユニット型伝導体β'-[H₃(Cat-EDO-TTF)₂]BF₄ (β'-1·BF₄)を合成し、特異な固相-固相相転換を観測した(Fig. 5-1)。この相転換では、 ユニット内の水素結合部が平面構造から屈曲構造へ幾何学的に変化することと連動して、 伝導層内の Cat-EDO-TTF⁺ 骨格の分子配列が、220 K 付近でβ'型からα型へと劇的に変化 していることが明らかとなった。さらに、伝導性は低抵抗半導体から高抵抗半導体へ、 また磁性も常磁性から非磁性へ変化することが分かった。結晶構造解析や物性測定の結 果から、この固相-固相相転換は、ユニット内「水素結合の幾何学的自由度」に由来し た大きな屈曲と、ユニット間における「スピン電子系の自由度」に由来する Cat-EDO-TTF⁺ 骨格間の π ダイマー化によるスピンシングレット化との協同的働きによって発現するこ とが示唆された。つまり、この固相-固相相転換は、ユニット内の水素結合の自由度と π 電子物性が相関した新規タイプの動的現象であることを見出した。



Fig. 5-1 水素結合ユニット型伝導体[H₃(Cat-EDO-TTF)₂]BF₄における水素結合ユニットの 屈曲を反映した、 β [']型から α 型への分子配列変化及び伝導性のスイッチング現象

第3章では、第2章で紹介した水素結合ユニット型伝導体 β' -1·BF₄と同型構造を有した 新規のアニオン置換体 β' -1·X (X = ClO₄, PF₆, AsF₆)を合成し、アニオン置換による化学圧 力効果がこの系の π 電子物性、また β' -1·BF₄の相転換現象に及ぼす影響について調査した。 アニオン置換により単位胞体積が増加するに従って、系統的にb軸が大きく伸長してお り、一方でa, c軸の変化は小さく異方的な負の化学圧力が働いていることが分かった。 抵抗率測定から、この負の化学圧力効果を反映して、アニオン体積の増加に依存した室 温抵抗率の上昇を示すことが分かった。また、 β' -1·BF₄に見られた相転換は、同型構造の β' -1·X (X = ClO₄, PF₆, AsF₆)では観測されなかった。特に、 β' -1·BF₄から β' -1·ClO₄へのわ ずかなアニオン体積変化(Δ V=+0.91%)で劇的に π 電子物性が変化するのは非常に珍し く、格子変調に敏感な相転移現象であることが示された。そのため、 β' -1·BF₄と β' -1·ClO₄ の結晶構造を詳細に比較し、 β' -1·BF₄の相転換では、ダイマー内でのより強いスピンシン グレット形成のエネルギーの利得に加えて、b軸方向の分子間 S···S コンタクトによる化 学圧力効果が相乗的に働くことが重要であることが示唆された。つまり、水素結合の幾 何学的自由度に由来したユニットの屈曲によって、分子間の歪みを解消していることが 示唆された (Fig. 5-2)。



Fig. 5-2 水素結合ユニット型伝導体[H₃(Cat-EDO-TTF)₂]BF₄の(a) 高温相と (b) 低温相: 幾何学的な水素結合自由度を利用して、化学圧力の解消とスピン電子系の安定化が協同 したスイッチング現象。

第4章では、②で示したように、分子間の水素結合様式を電子構造と共に変調させる ために、カテコールを2つ縮環した新規のドナー分子(H₂Cat)₂-TTF を合成し、そのドナー を用いて、多様な水素結合電荷自由度とπ電子物性が相関した純有機伝導体結晶0-2 を合 成することに成功した。この系では、-1 価の荷電様式の水素結合で繋がれたユニット構 造に加えて、中性の水素結合で繋がれたディスオーダーユニット構造が存在し、この多 様な水素結合電荷自由度 (Fig. 5-3)、具体的にはカテコール部分の脱プロトンと酸化の度 合いによって TTF の酸化状態が制御されていることが分かった。



Fig. 5-3 (H₂Cat)₂-TTF を基盤とした水素結合によって TTF 酸化状態が制御された純有 機伝導体**θ-2**。–1 価、および 0 価の水素結合の電荷自由度を反映して、すべてドナー分子 が~+0.25 価 (7/8 フィリング)の酸化状態をしている。

本研究では、分子の電子構造及び分子間の水素結合様式を変調した 2 種類の Cat-TTF 誘導体のドナー分子を用いて、水素結合ユニットを基盤とした新奇な有機伝導体を開発 し、水素結合の自由度と π 電子物性の相関した π 電子物性とその動的現象として、劇的 な相転換や、特異な電荷をもつ自己ドープ型純有機伝導体を見出すことに成功した。こ れらの結果は、水素結合の自由度と π 電子物性が相関した多様な分子性物質の開発に対 する重要な指針を与えるとともに、機能性有機材料・デバイスへの展開にとっても意義 深い結果であると考えられる。

- J. Yoshida, A. Ueda, A. Nakao, R. Kumai, H. Nakao, Y. Murakami and H. Mori, "Solid-solid phase interconversion in an organic conductor crystal: hydrogen-bond-mediated dynamic changes in π-stacked molecular arrangement and physical properties.", *Chem. Commun.*, 50, 15557-15560 (2014).
- S. J. Krivickas, C. Hashimoto, <u>J. Yoshida</u>, A. Ueda, K. Takahashi, J. D. Wallis, H. Mori, "Synthesis of racemic and chiral BEDT-TTF derivatives possessing hydroxy groups and their achiral and chiral charge transfer complexes", *Beilstein J. Org. Chem.*, 11, 1561-1569 (2015).

講演目録

国内学会

- <u>吉田順哉</u>、上田 顕、加茂博道、森 初果 「エチレンジオキシ基を有するカテコー ル縮環型 TTF 誘導体を用いた新規有機伝導体の構造と物性」『第7回分子科学討論会』、 京都、2013 (ポスター発表)
- <u>吉田順哉</u>、上田 顕、中尾朗子、熊井玲児、中尾裕則、村上洋一、森 初果 「新規 水素結合ユニット型有機伝導体 [H₃(Cat-EDO-TTF)₂]BF₄のドナー配列変化を伴う相 転移」
 『日本化学会第 94 春季年会』、名古屋大学、2014(ロ頭発表)
- <u>吉田順哉</u>、上田 顕、中尾朗子、熊井玲児、中尾裕則、村上洋一、森 初果 「水素 結合ユニット型有機伝導体β'-[H₃(Cat-EDO-TTF)₂]X (X = BF₄, ClO₄, PF₆, AsF₆)の対アニ オン変化に対する系統的な構造物性評価」『第8回分子科学討論会』、広島大学、2014 (ポスター発表、優秀ポスター賞受賞)
- <u>吉田順哉</u>、上田 顕、森 初果「カテコールが二個縮環した TTF 誘導体を用いた新 規有機伝導体の合成とその構造、物性」 『日本化学会第 95 春季年会』、日本大学、 2015(口頭発表)
- 5. <u>吉田順哉</u>、上田 顕、中尾朗子、熊井玲児、中尾裕則、村上洋一、森 初果「カテコ ール縮環型 TTF を基盤とした有機伝導体:TTF 骨格の化学修飾による水素結合相互 作用と物性の変調」『第9回分子科学討論会』、東京工業大学、2015(ロ頭発表)
- 他 ポスター発表3件

国際学会

- J. Yoshida, A. Ueda, H. Kamo, and H. Mori, "Structure and Physical Properties of Novel Organic Conductors Based on Catechol-fused TTF Derivative Having an Ethylenedioxy Group" in ISSMM, International School and Symposium on Molecular Materials, Tokyo, Japan, 2013 (poster)
- J. Yoshida, A. Ueda, A. Nakao, R. Kumai, H. Nakao, Y. Murakami, and H. Mori, "Novel Hydrogen-bonded-unit-type Organic Conductor [H₃(Cat-EDO-TTF)₂]BF₄ that Undergoes Phase Transition with Drastic Change of Donor Arrangement" in ICSM, 5th International Conference on Superconductivity and Magnetism, Turku, Finland, 2014 (poster)

本研究は、東京大学物性研究所教授の森初果先生のもとに行われました。

指導教員である森初果教授には、物性研究所での3年間の研究生活において、丁寧か つ熱心なご指導を賜りました。心より深く感謝いたします。

上田顕助教には、普段の研究では合成から装置の使い方、研究相談、論文作成など、 丁寧なご指導をいただきました。また、研究に対する姿勢や、学会発表の仕方など、研 究者として大切なことを数多く教えていただきました。心より深く感謝いたします。

総合科学研究機構 (CROSS) の中尾朗子先生、物質構造科学研究所の熊井玲児先生、中 尾裕則先生、村上洋一先生には、高エネルギー加速器研究機構での実験に際し、大変お 世話になりました。厚く御礼申し上げます。

東京大学の岡本博先生には、ラマン分光測定の実験の際に、大変お世話になりました。 厚く御礼申し上げます。

博士学位論文審査をお引き受け頂いた佐々木裕次先生 (東京大学新領域創成科学研究 科教授)、山室修先生 (東京大学物性研究所教授)、柴山充弘先生 (東京大学物性研究所教 授)、岡本敏宏先生 (東京大学新領域創成科学研究科准教授) に厚く御礼申し上げます。

本研究室秘書の川井明子氏には、伝票処理や旅費申請の手続き等を行っていただき、 大変助かりました。深く感謝いたします。

また、本研究室所属の東野寿樹博士、砂入允哉氏、寺師拓也氏、土居諒平氏のおかげ で、楽しく充実した研究室生活を送ることができましたことを、心から感謝いたします。 最後に大学院での就学の機会を与えてくれた両親に感謝申し上げます。

89